

2027年3月期第1四半期(2026年4月～6月) 決算説明資料

2026年8月6日

株式会社 KOKUSAI ELECTRIC

注意事項

本資料及び本資料にて提供される情報は企業情報等の提供のために作成されたものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他有価証券の勧誘を構成するものではありません。

■ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社グループの事業計画、将来予測などは、当社グループが作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、将来の結果や業績を保証するものではありません。さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果は計画、予測と大きく異なる結果となる可能性があります。当社グループは、適用される法令または証券取引所の規則により要求される場合を除き、本資料に含まれるいかなる情報についても、今後生じる事象に基づき更新または改訂する義務を負うものではありません。なお、当社グループの経営成績、財政状態、キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があるとして認識している主なリスクは、有価証券報告書に記載しております。

■ 為替リスクについて

当社グループにおける海外売上収益は高い水準で推移しております。また、当社グループの外貨建ての資産および負債の評価は為替相場の変動により影響を受けます。当社グループ製品の輸出売上は、ほとんどが円建てで行われておりますが、一部に外貨建売上および費用計上もあり、為替相場の変動により影響を受けることがあります。

■ 経営指標について

当社グループは、企業価値の向上に向けて経営成績の推移を把握するため、調整後営業利益、調整後当期(四半期)利益を重要な経営指標として位置付けております。調整の内容につきましては、決算短信に記載しております。調整後営業利益、調整後当期(四半期)利益につきましては、同様または類似の名称を用いている他社の経営指標と内容が異なる場合があります、比較可能性がない場合があります。

■ 会計基準について

当社グループは2021年3月期より国際会計基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しております。

■ 数字の処理について

本資料に記載された金額(一部を除く)は、億円未満を四捨五入しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



2027年3月期第1四半期連結決算概要

2027年3月期第1四半期連結決算概要

- 半導体デバイス市場は、生成AI用途の高性能なLogicやDRAMを中心に世代交代・生産規模拡大投資が前期に増して高水準で推移。NANDは世代交代投資が中心。民生電子機器向けや自動車・産業機器向けの需要回復は緩やか。
- 当社1Qは、DRAM、Logic向けを中心とした装置販売、サービス売上の伸長により前年同期比で増収増益。通期決算発表時の業績予想からは売上・利益ともに上振れて着地。

2027年3月期連結業績予想・配当予想と今後の見通し

- 半導体デバイスメーカーは高性能デバイス向けを中心に、世代交代や生産規模拡大に向けた設備投資への急加速が続く見通し。
- デバイスメーカーの急速な設備投資の拡大に伴い、装置売上が前回予想*1を大きく上回る見通しとなったことから、第2四半期(中間期)および通期連結業績予想と配当予想を上方修正。

連結業績サマリー

1Qの売上・利益は、前年同期比・直前四半期比ともに増収増益。
売上総利益率は、前年同期比では製品構成の変化により低下したものの直前四半期比では上昇。売上収益の増加により調整後営業利益以下の利益率は前年同期・直前四半期を上回る水準。

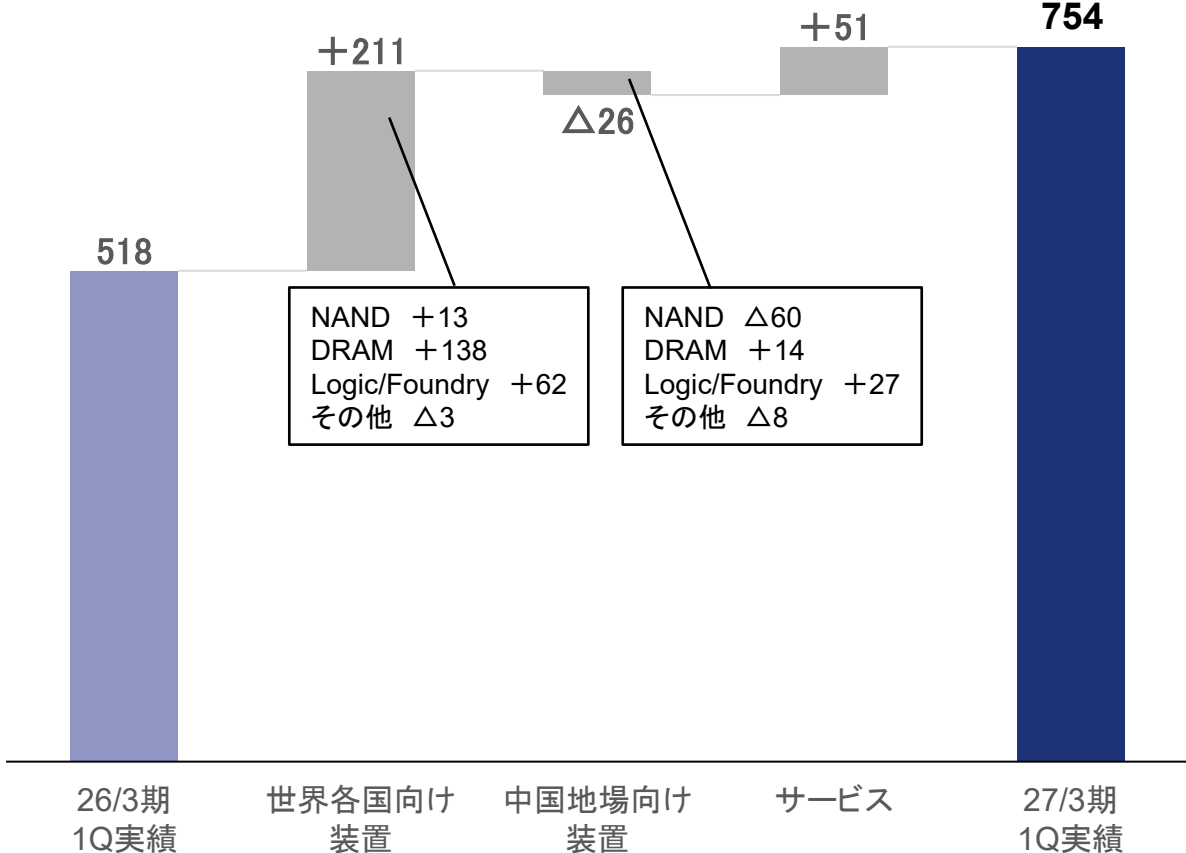
(億円)	26/3期					27/3期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	前年同期比	前四半期比
売上収益	518	654	559	620	2,351	754	+45.6%	+21.6%
売上総利益	222	273	229	244	968	307	+38.1%	+25.6%
売上総利益率	42.9%	41.7%	41.0%	39.4%	41.2%	40.7%	△2.2pts	+1.3pts
調整後営業利益	109	144	113	110	476	174	+59.3%	+58.4%
調整後営業利益率	21.1%	22.1%	20.2%	17.7%	20.2%	23.0%	+1.9pts	+5.3pts
調整後当期(四半期)利益	76	98	83	84	341	125	+65.1%	+49.0%
調整後当期(四半期)利益率	14.7%	15.0%	14.8%	13.6%	14.5%	16.6%	+1.9pts	+3.0pts
営業利益	97	130	98	93	418	159	+63.9%	+70.9%
営業利益率	18.8%	19.9%	17.6%	15.0%	17.8%	21.1%	+2.3pts	+6.1pts
税引前当期(四半期)利益	93	128	94	92	407	157	+68.9%	+71.8%
税引前当期(四半期)利益率	18.0%	19.6%	16.9%	14.8%	17.3%	20.9%	+2.9pts	+6.1pts
当期(四半期)利益	68	88	73	73	301	116	+70.6%	+58.8%
当期(四半期)利益率	13.1%	13.4%	13.0%	11.7%	12.8%	15.3%	+2.2pts	+3.6pts
研究開発費	39	48	42	54	183	45	+15.9%	△17.8%
設備投資額	23	52	40	53	169	48	+109.8%	△9.5%
減価償却費	34	35	36	37	143	39	+15.0%	+5.2%
1株当たり配当金(円)	-	18	-	19	37	-	-	-

2027年3月期第1四半期実績 増減要因

売上収益は、世界各国向け装置売上とサービス売上が伸長し、前年同期比46%増加。調整後営業利益は、販売増加が大きく寄与し、前年同期比59%増加。

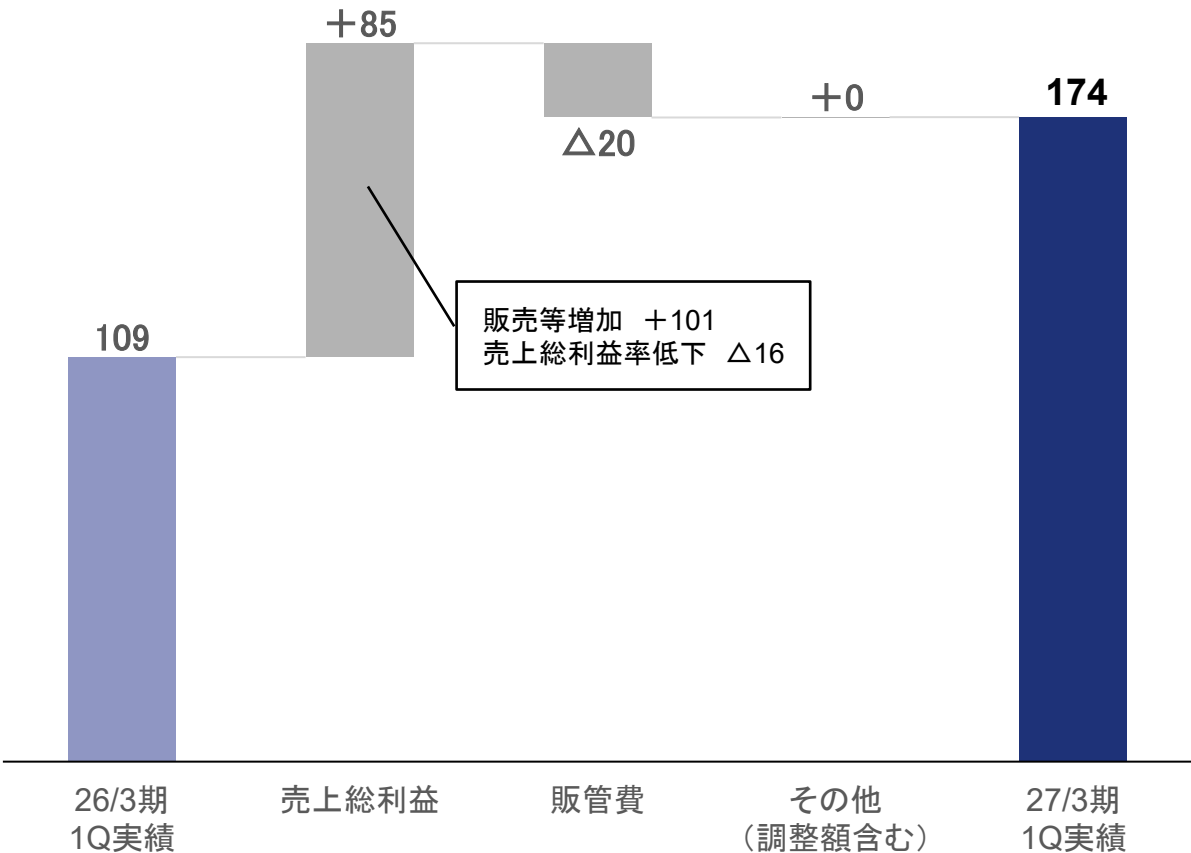
売上収益

(億円)



調整後営業利益

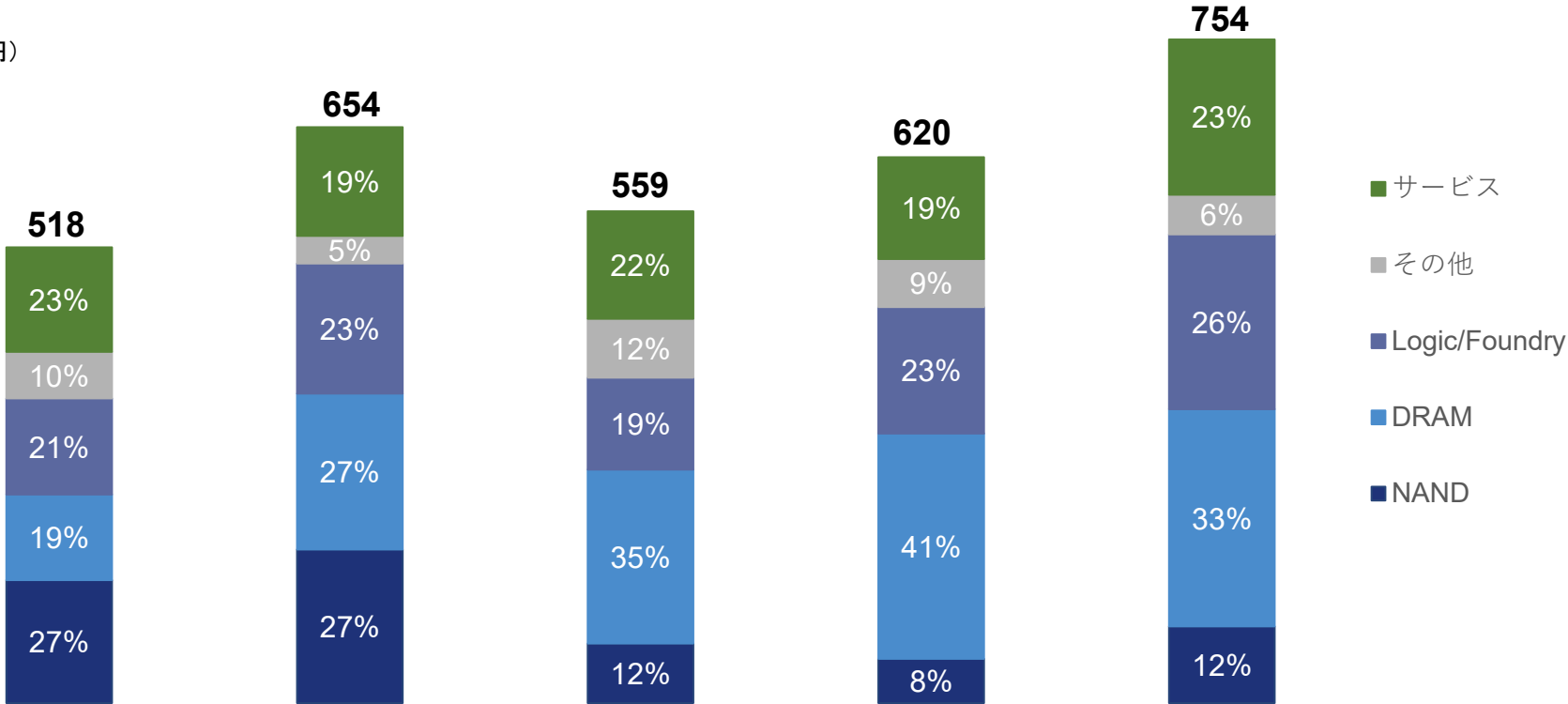
(億円)



四半期別売上収益 アプリケーション別

1Qは前年同期比でNAND向けが34%減少も、DRAM向けは158%増加、Logic/Foundry向けは82%増加。
直前四半期比ではDRAM向けが2%減少も、NAND向けは84%増加、Logic/Foundry向けは38%増加。

(億円)

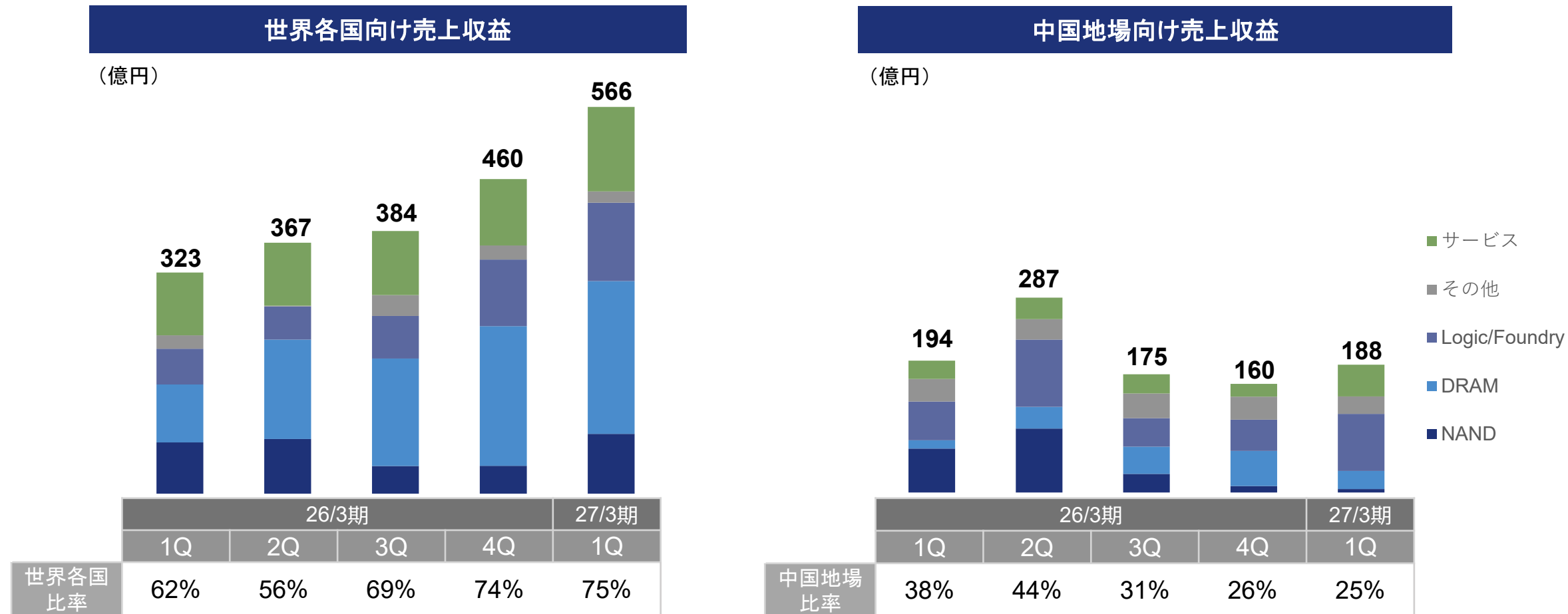


(億円)

	26/3期				27/3期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
サービス売上	119	124	122	116	170
装置売上	399	530	437	505	584

四半期別売上収益 アカウント別*1

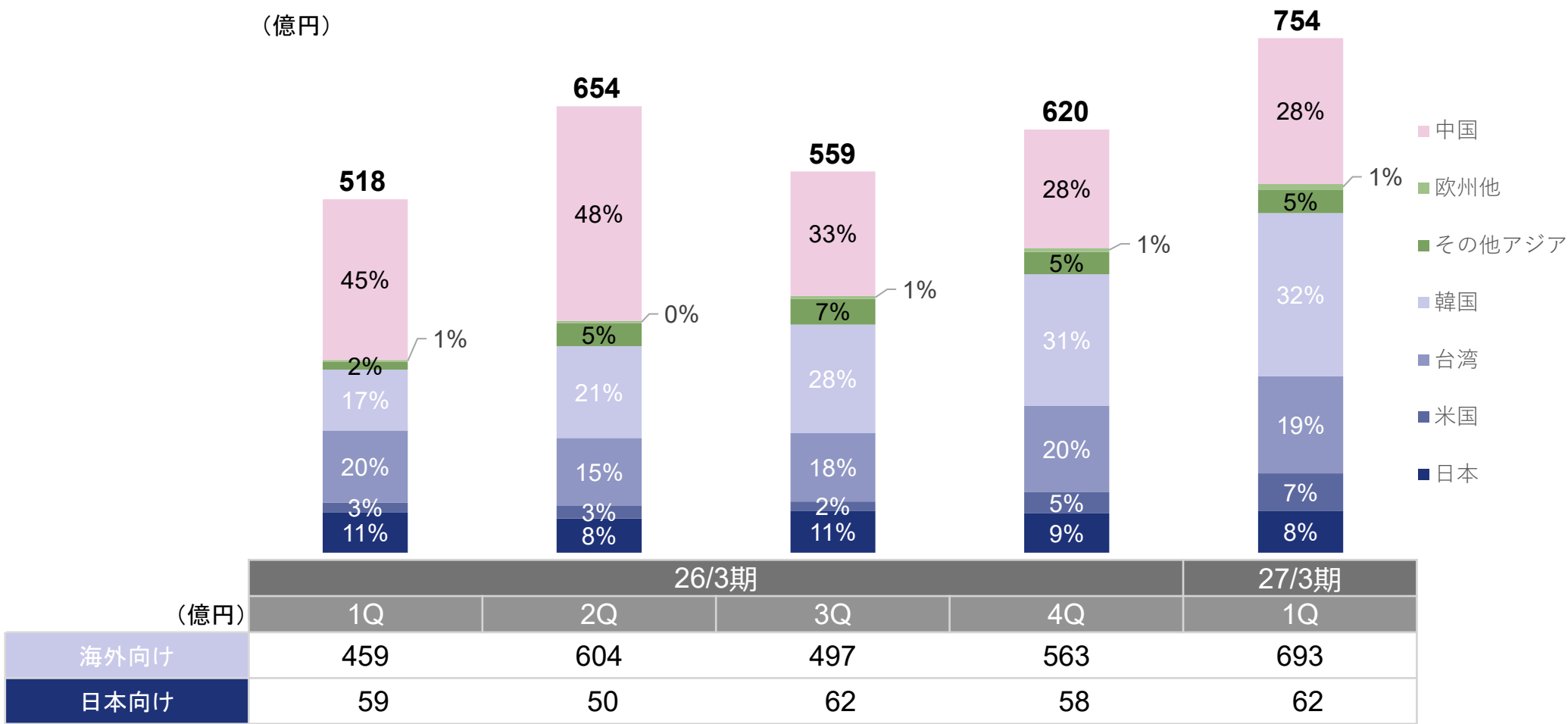
1Qの世界各国向け売上は、前年同期比・直前四半期比ともに主要アプリケーション向け装置売上とサービス売上が増加。中国地場向け売上は、前年同期比・直前四半期比ともにLogic/Foundry向け装置売上とサービス売上が増加。世界各国向け売上の伸長により中国地場向け売上比率は25%に低下。



*1 世界各国デバイスメーカー(中国以外に本拠のあるメーカー)向け、中国地場デバイスメーカー向けの区分

四半期別売上収益 仕向地別

1Qの中国向け売上は、前年同期比で減少、直前四半期比では増加。1Qの中国以外では、すべての地域で前年同期比・直前四半期比ともに増加。中国向け売上構成比率は、直前四半期と同水準の28%。

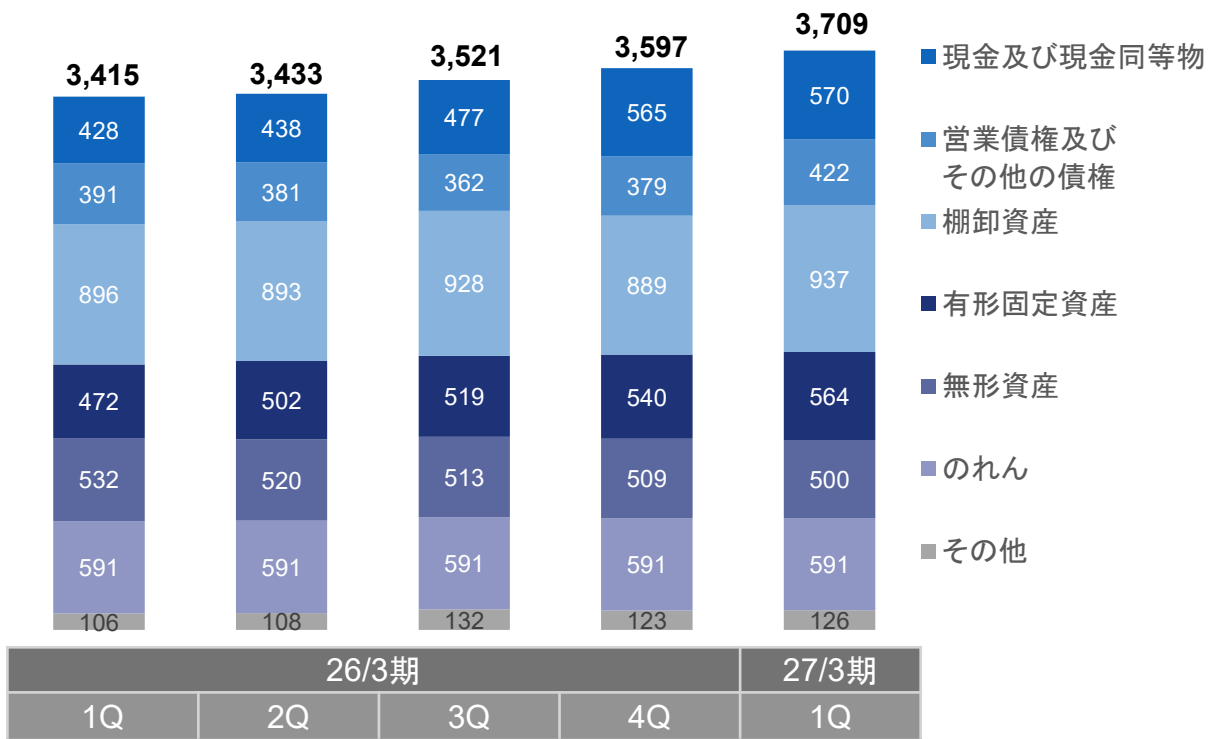


四半期別貸借対照表

資産合計は、生産の増加に伴う棚卸資産の増加、営業債権及びその他の債権の増加により前期末と比べ112億円増加。資本合計は、利益剰余金の増加等により前期末と比べ56億円増加。

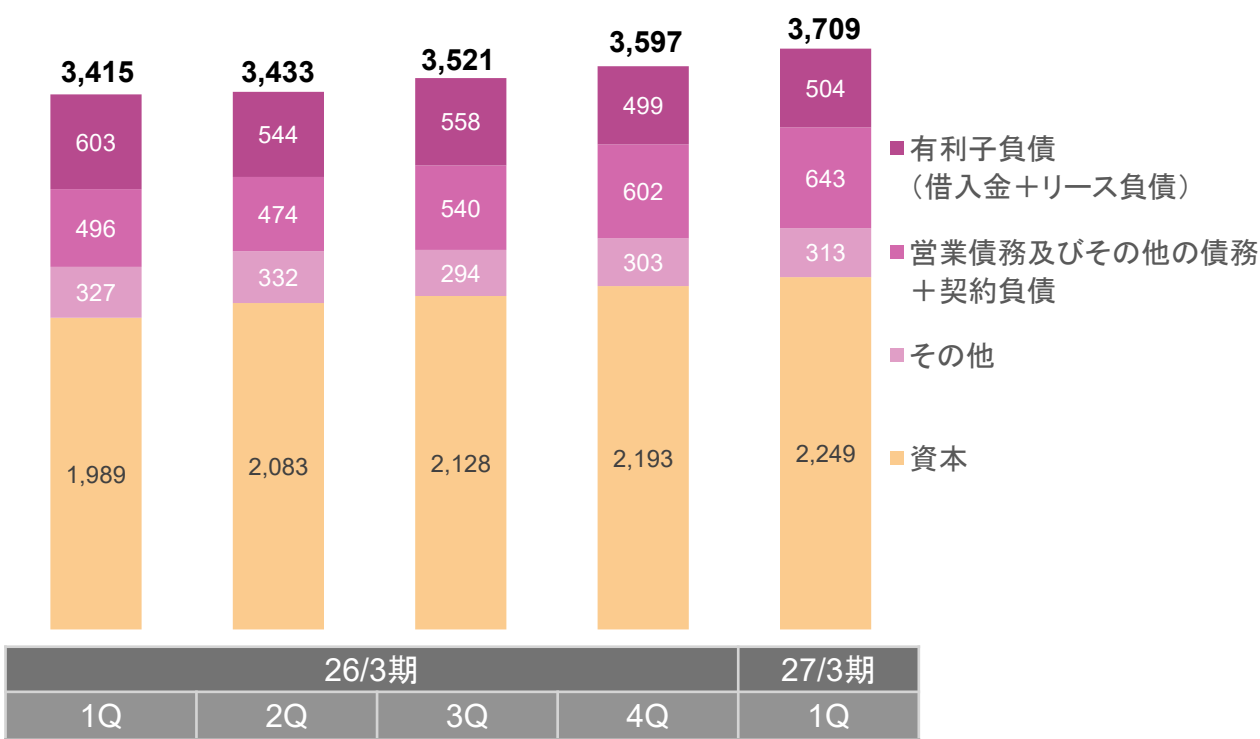
資産

(億円)



負債／資本

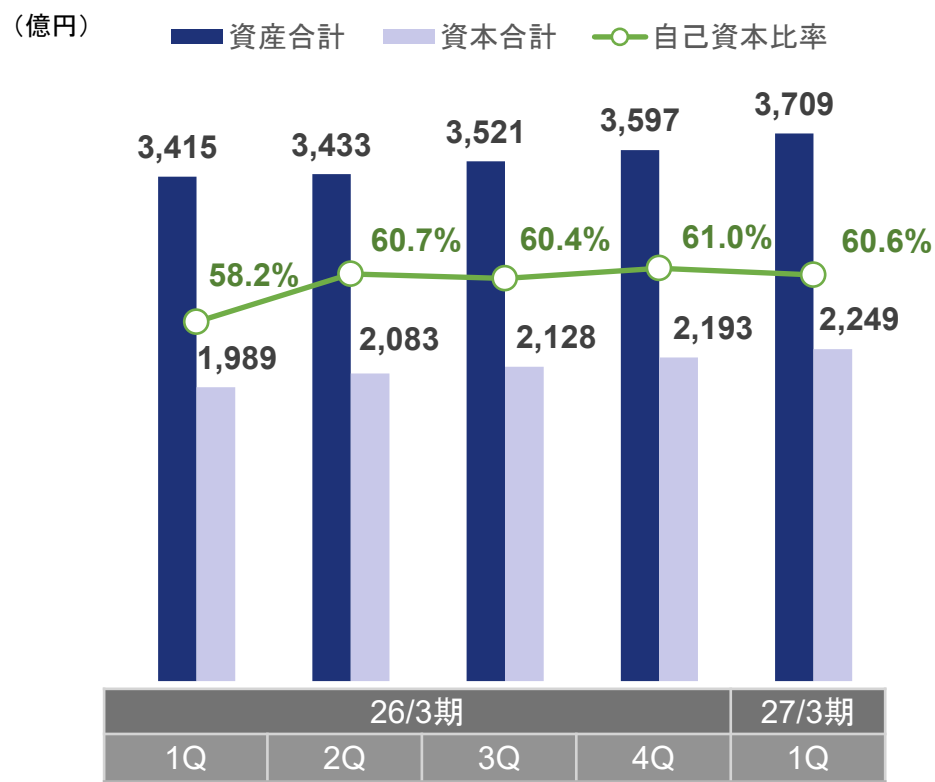
(億円)



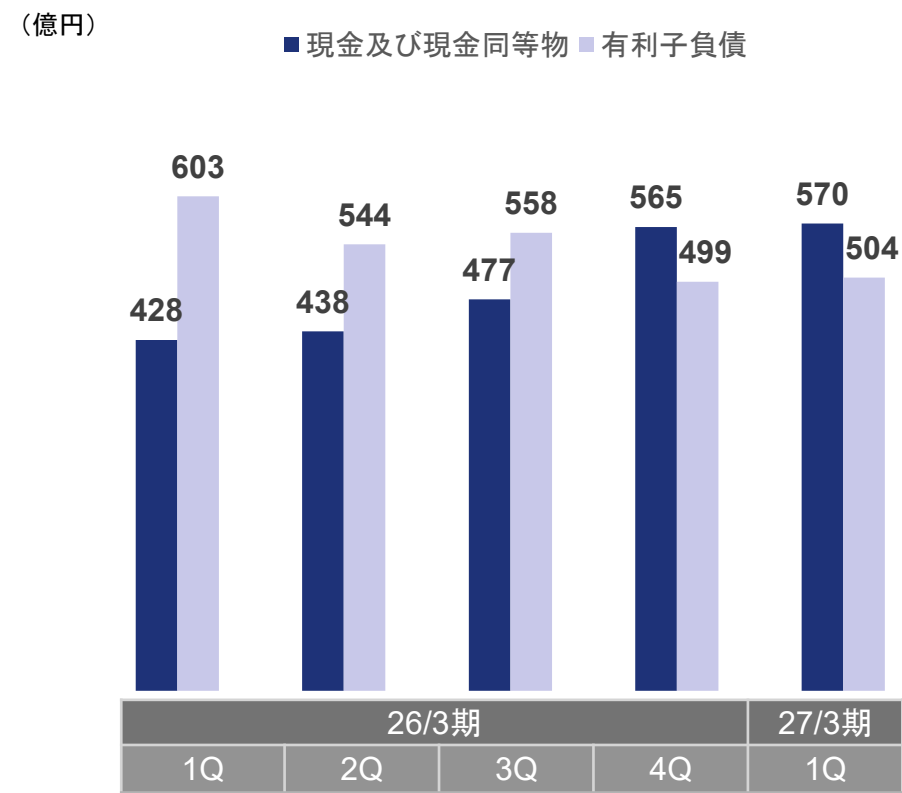
四半期別自己資本比率&現金及び現金同等物／有利子負債

自己資本比率は、前期末比で0.4ポイント減少したものの60%台。
ネットキャッシュは前期末と同水準の66億円を維持。

資産合計／資本合計／自己資本比率

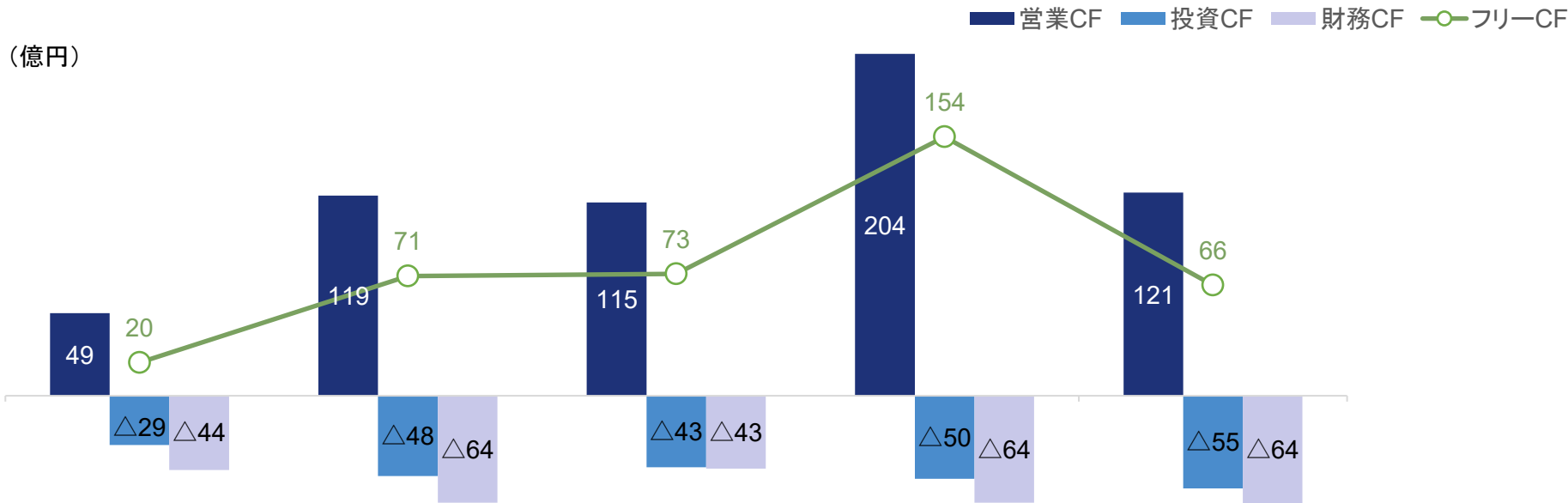


現金及び現金同等物／有利子負債



四半期別キャッシュ・フロー

営業CFが投資CFを上回り、フリーCFは66億円に。
財務CFは配当金の支払いや自己株式取得等により、64億円の支出。

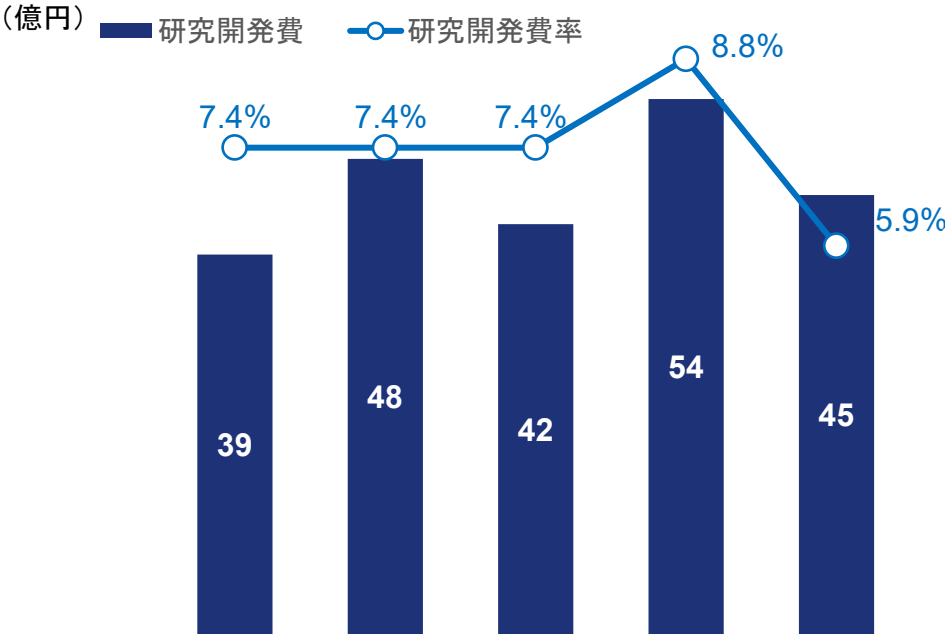


(億円)	26/3期				27/3期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
営業CF	+ 49	+ 119	+ 115	+ 204	+ 121
投資CF	△29	△48	△43	△50	△55
財務CF	△44	△64	△43	△64	△64
フリーCF	+ 20	+ 71	+ 73	+ 154	+ 66
現金及び現金同等物残高	428	438	477	565	570

四半期別研究開発費／設備投資額／減価償却費

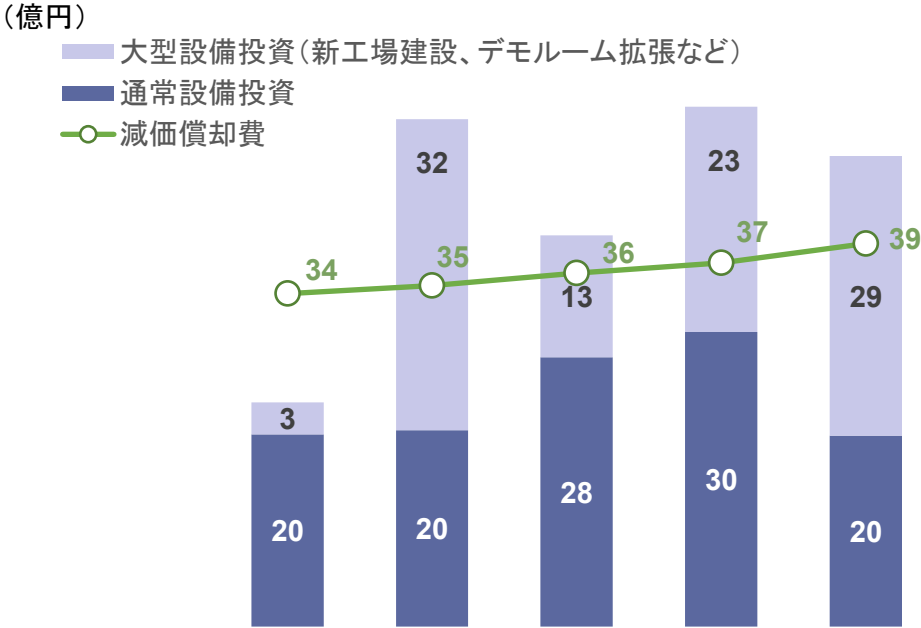
1Qの研究開発費、設備投資額、減価償却費は計画通り推移。
売上収益の増加に伴い、研究開発費率は5.9%に低下。

研究開発費



(億円)	26/3期				27/3期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
研究開発費	39	48	42	54	45
売上収益比	7.4%	7.4%	7.4%	8.8%	5.9%

設備投資額／減価償却費



(億円)	26/3期				27/3期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
設備投資額計	23	52	40	53	48
売上収益比	4.4%	8.0%	7.2%	8.6%	6.4%
減価償却費	34	35	36	37	39
売上収益比	6.6%	5.3%	6.5%	6.0%	5.2%



2027年3月期連結業績予想・配当予想

2027年3月期第1四半期連結決算概要

- 半導体デバイス市場は、生成AI用途の高性能なLogicやDRAMを中心に世代交代・生産規模拡大投資が前期に増して高水準で推移。NANDは世代交代投資が中心。民生電子機器向けや自動車・産業機器向けの需要回復は緩やか。
- 当社1Qは、DRAM、Logic向けを中心とした装置販売、サービス売上の伸長により前年同期比で増収増益。通期決算発表時の業績予想からは売上・利益ともに上振れて着地。

2027年3月期連結業績予想・配当予想と今後の見通し

- 半導体デバイスメーカーは高性能デバイス向けを中心に、世代交代や生産規模拡大に向けた設備投資への急加速が続く見通し。
- デバイスメーカーの急速な設備投資の拡大に伴い、装置売上が前回予想*1を大きく上回る見通しとなったことから、第2四半期(中間期)および通期連結業績予想と配当予想を上方修正。

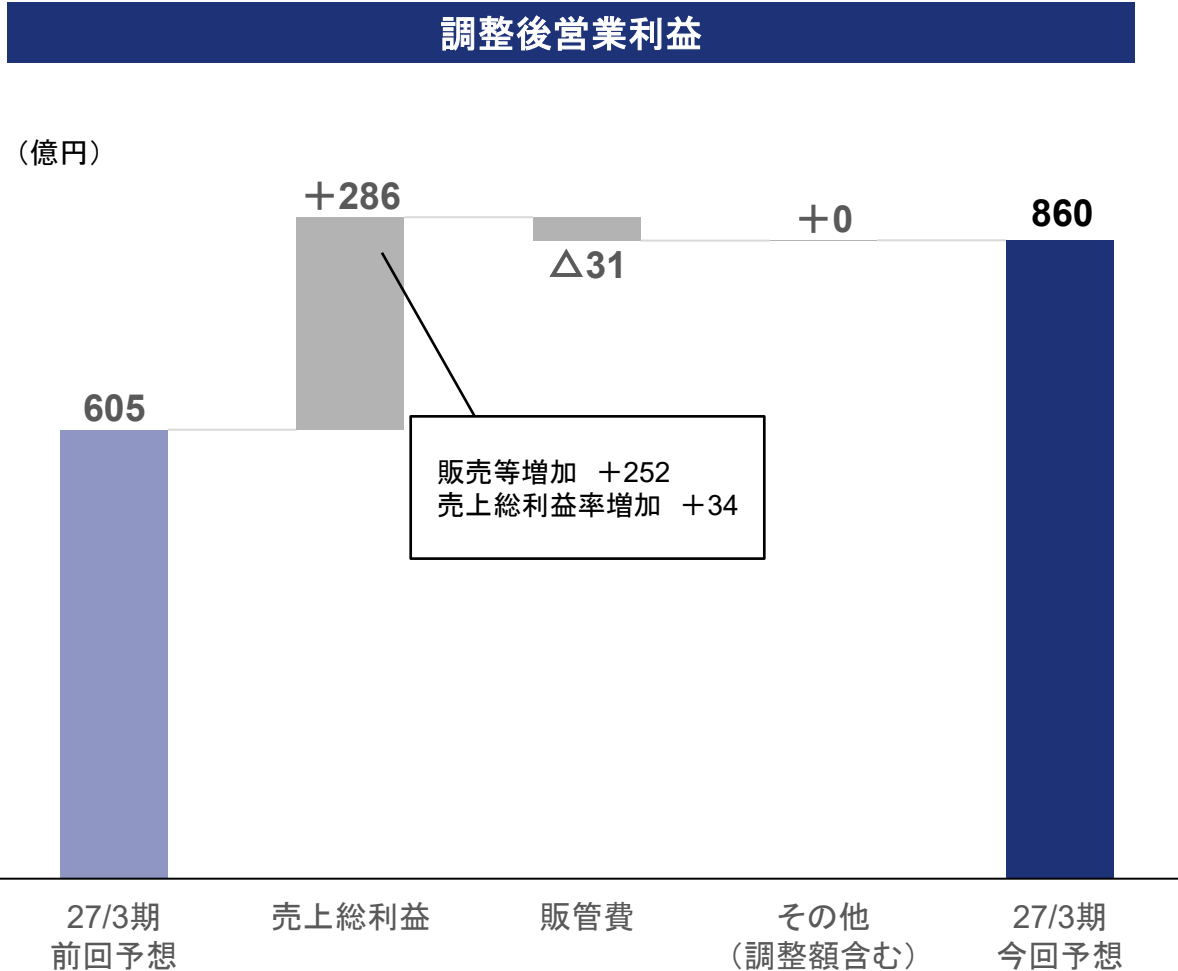
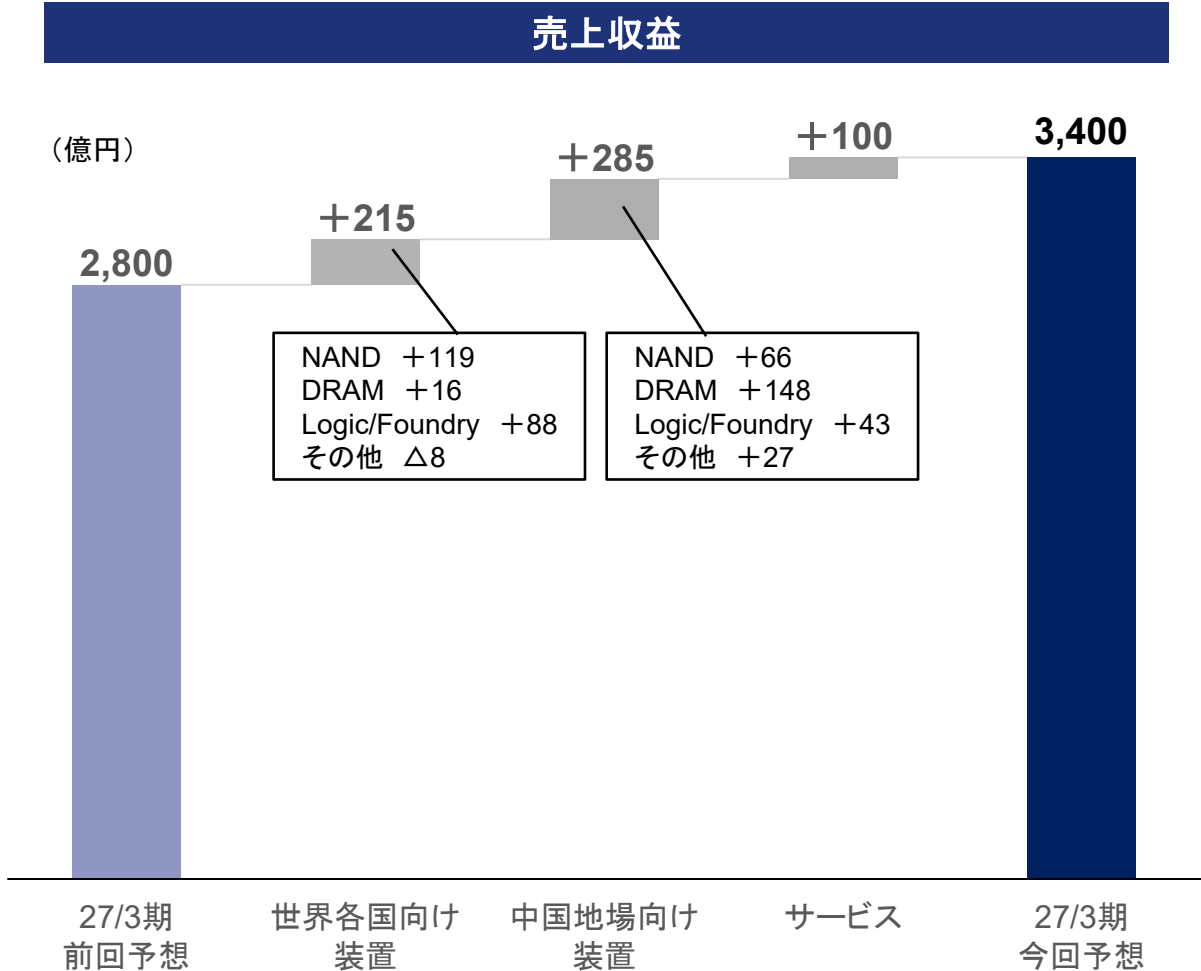
2027年3月期業績・配当予想(変更あり)

通期で売上収益は21%引き上げ前期比45%増加、調整後営業利益は42%引き上げ前期比81%増加、調整後当期利益は40%引き上げ前期比76%増加、にそれぞれ修正。年間配当予想は前回47円から18円増配し、65円に引き上げ。

(億円)	26/3期			27/3期									
	実績			前回予想			今回予想						
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期	前期比	下期	前期比	通期	前期比	前回予想比
売上収益	1,172	1,179	2,351	1,523	1,277	2,800	1,610	+ 37.4%	1,790	+ 51.8%	3,400	+ 44. 6%	+ 21.4%
売上総利益	495	473	968	641	535	1,176	684	+ 38.2%	778	+ 64.5%	1,462	+ 51.0%	+ 24.3%
売上総利益率	42.2%	40.1%	41.2%	42.1%	41.9%	42.0%	42.4%	+0.2pts	43.5%	+3.4pts	43.0%	+1.8pts	+1.0pts
調整後営業利益	253	223	476	355	250	605	392	+ 54.7%	467	+ 109.4%	860	+ 80.7%	+ 42.1%
調整後営業利益率	21.6%	18.9%	20.2%	23.4%	19.5%	21.6%	24.4%	+2.8pts	26.1%	+7.2pts	25.3%	+5.1pts	+3.7pts
調整後当期(半期)利益	174	167	341	250	179	429	278	+ 59.9%	322	+ 92.8%	600	+ 76.0%	+ 39.9%
調整後当期(半期)利益率	14.8%	14.2%	14.5%	16.4%	14.0%	15.3%	17.3%	+2.5pts	18.0%	+3.8pts	17.7%	+3.2pts	+2.4pts
営業利益	227	191	418	325	220	545	356	+ 56.8%	438	+ 129.3%	794	+ 89.8%	+ 45.7%
営業利益率	19.4%	16.2%	17.8%	21.4%	17.2%	19.5%	22.1%	+2.7pts	24.5%	+8.3pts	23.4%	+5.6pts	+3.9pts
税引前当期(半期)利益	222	186	407	319	215	534	351	+ 58.4%	432	+ 132.2%	783	+ 92.2%	+ 46.6%
税引前当期(半期)利益率	18.9%	15.8%	17.3%	21.0%	16.8%	19.1%	21.8%	+2.9pts	24.1%	+8.3pts	23.0%	+5.7pts	+3.9pts
当期(半期)利益	156	145	301	229	159	388	254	+ 63.3%	301	+ 108.3%	555	+ 84.4%	+ 43.0%
当期(半期)利益率	13.3%	12.3%	12.8%	15.1%	12.4%	13.9%	15.8%	+2.5pts	16.8%	+4.5pts	16.2%	+3.4pts	+2.3pts
1株当たり配当金(円)	18	19	37	23	24	47	32	+ 14	33	+ 14	65	+ 28	+ 18
配当性向 〈調整後当期利益ベース〉	—	—	25.3%	—	—	25.6%	—	—	—	—	25.2%	△0.1pts	△0.4pts

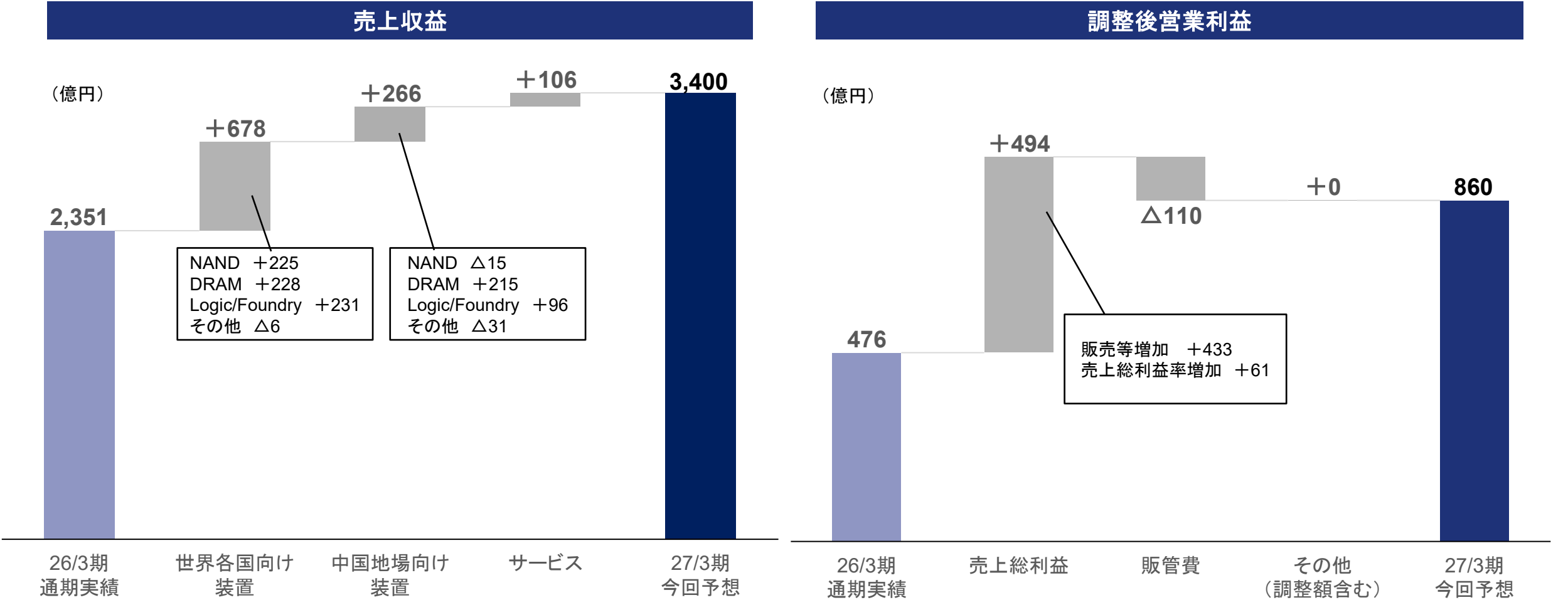
2027年3月期業績予想 前回予想比増減要因

売上収益は、装置売上的大幅な上振れを見込み前回予想比で21%の引き上げ。
調整後営業利益は、販売増加と売上総利益率の上昇を見込み42%の引き上げ。



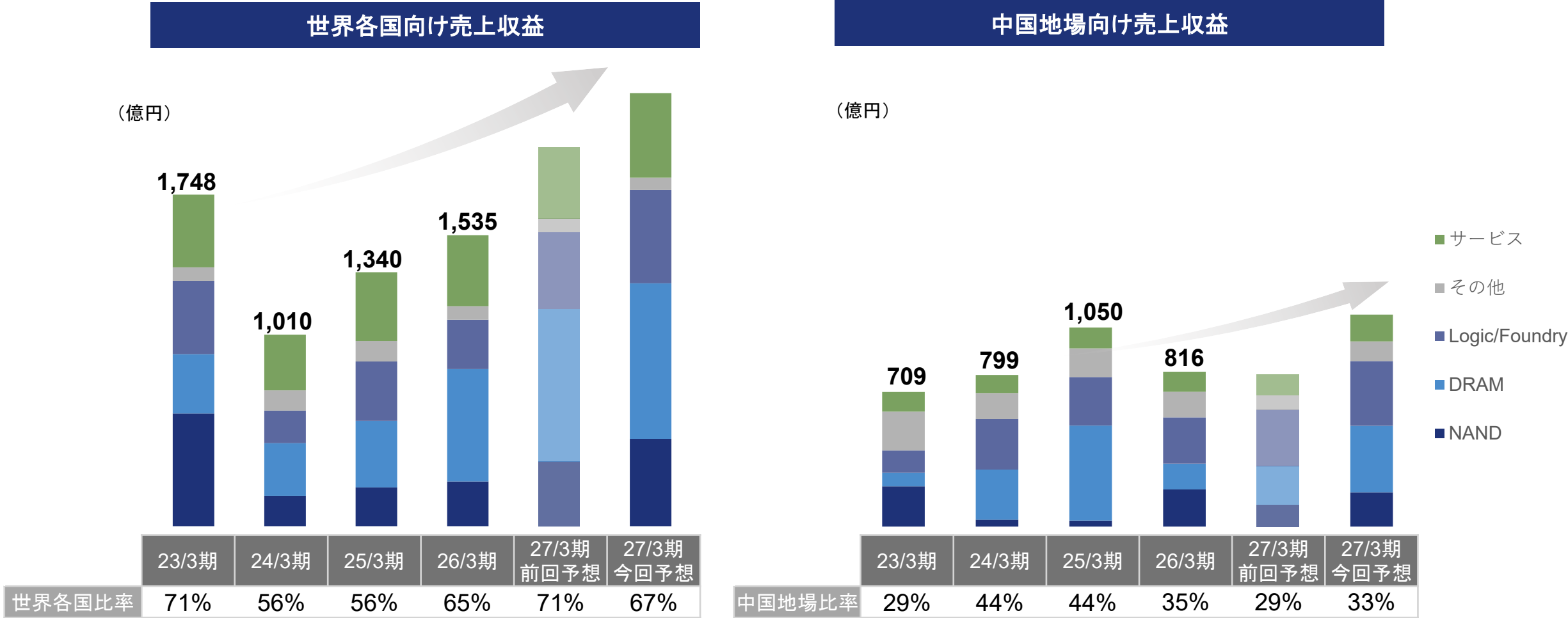
2027年3月期業績予想 前期比増減要因(変更あり)

売上収益は、世界各国向け装置売上、中国地場向け装置売上、サービス売上のそれぞれが増加し、前期比45%増加となる見通し。調整後営業利益は、販売増加と売上総利益率の上昇により81%増加の見通し。



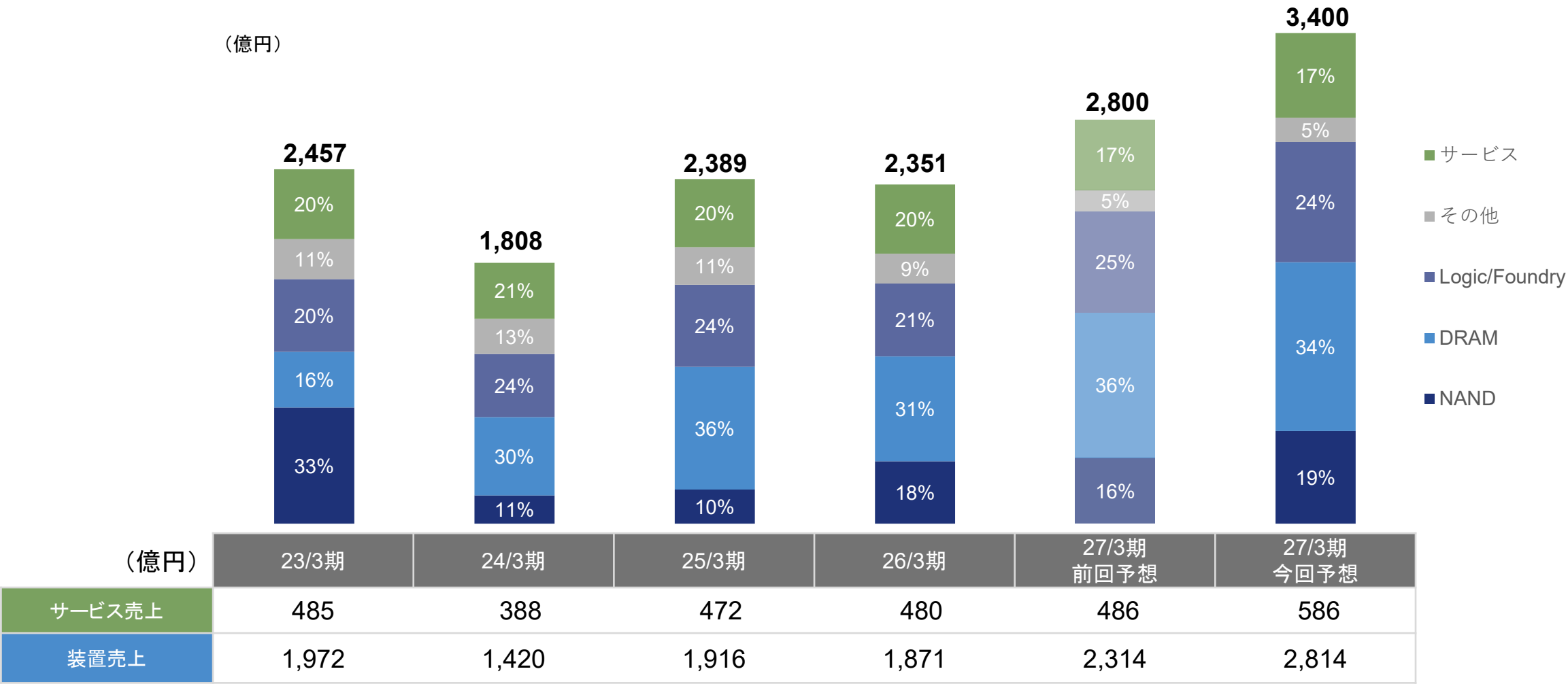
2027年3月期業績予想 アカウント別*1売上収益(変更あり)

世界各国向け売上は、主にNANDとLogic/Foundry向け装置の需要拡大により前回予想比で14%上方修正し、前期比では49%増加の見通し。中国地場向け売上は、主にDRAM向け装置の需要拡大により前回予想比で39%上方修正し、前期比では37%増加する見通し。



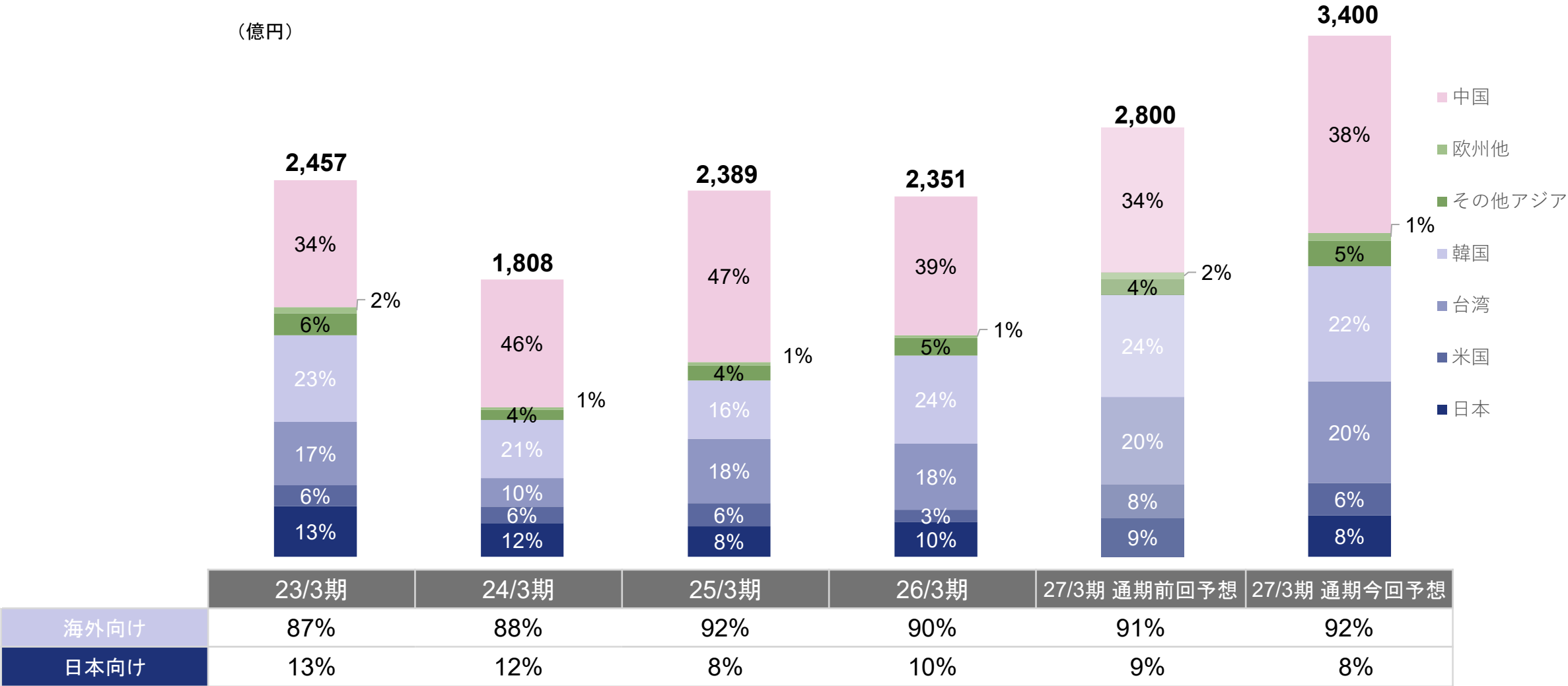
2027年3月期業績予想 アプリケーション別装置売上収益(変更あり)

前期比でNAND向けは49%増加、DRAM向けは61%増加、Logic/Foundry向けは65%増加、サービス売上は22%増加とそれぞれ増加の見通し。サービス売上比率は17%の見通し。



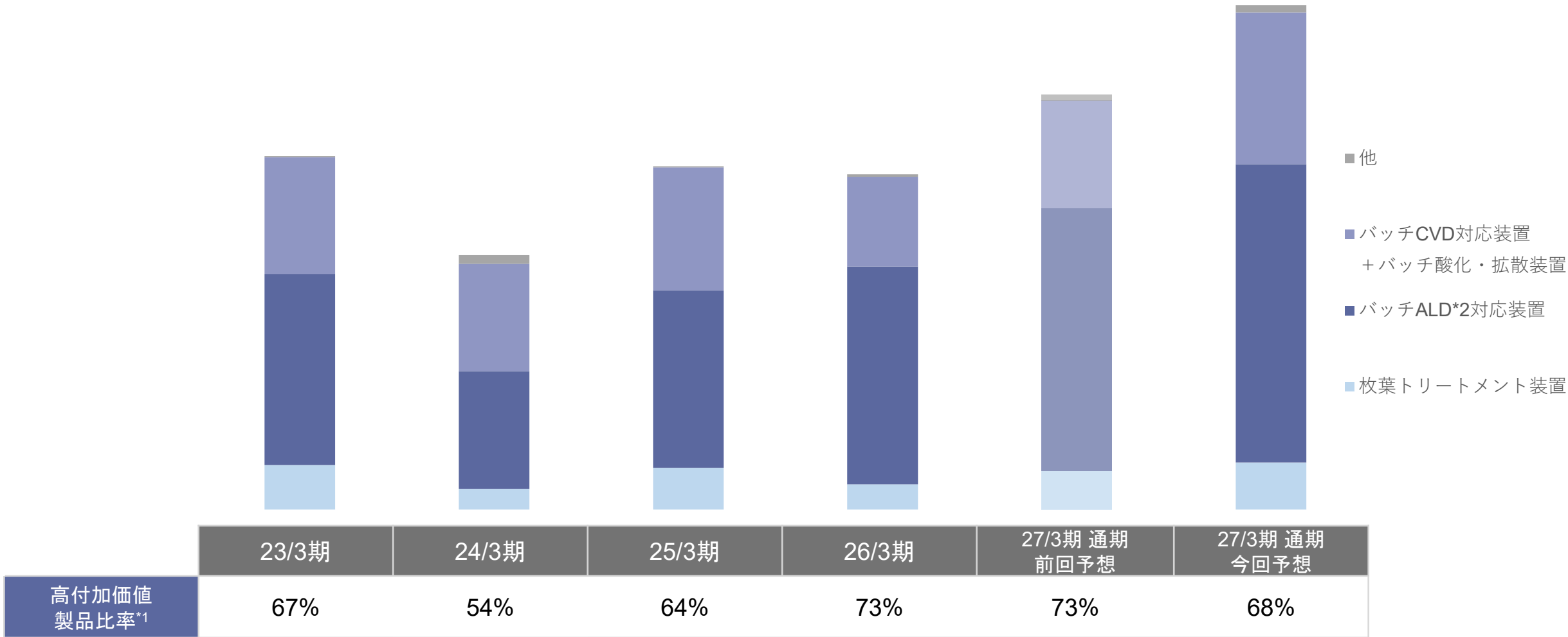
2027年3月期業績予想 仕向地別売上収益(変更あり)

前期比ですべての地域仕向け売上が増加。中国仕向け比率は38%の見通し。



2027年3月期業績予想 装置別売上収益(変更あり)

27年3月期の高付加価値製品比率^{*1}は68%となる見通し。
今後デバイスの世代交代によりバッチALD^{*2}対応装置と枚葉トリートメント装置の導入は加速していく見通し。



^{*1}高付加価値製品比率はバッチALD対応装置と枚葉トリートメント装置を合算した比率です。
^{*2}当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。



今後の見通し

事業環境の見通し

AI関連の需要がデバイスメーカーの設備投資を引き続き強力にけん引、高性能デバイス向け装置需要はさらに増加する見通し。

半導体デバイス市場

- AI関連の需要がデバイスメーカーの設備投資を引き続き強力にけん引。DRAMを中心に高性能デバイス向けの投資は大きく拡大。
- AI関連以外の産業機器向けデバイスの需要は回復局面。
- 中長期的には、データセンターの拡充への投資、民生電子機器の需要回復等により、大きな成長に期待。

2026年の市場動向

- DRAMとNANDはAI市場の拡大で需要が急増し、価格上昇
- DRAMはLogic/Foundryと同程度の市場規模に拡大
- Logic/Foundryは先端向けを中心に継続して需要増加

半導体製造装置(WFE)市場

- AI関連の需要拡大に伴って、高性能デバイス向け装置への需要はさらに増加。
- 成熟ノード向け装置への需要は今後の回復に期待。
- 半導体デバイス市場の拡大に伴い、半導体製造装置市場も中長期的に大きな成長に期待。

2026年の市場見通し(2025年比)

- 市場全体: +25%以上
- NAND向け装置市場: +25%前後
- DRAM向け装置市場: +40%前後
- Logic/Foundry+その他市場: +20%前後

中期経営計画のアップデート

24年の中期経営計画策定時から市場環境が大きく変化したことを受け、中期目標の達成時期とアプリケーション別売上構成比を26年5月13日に見直し。急速な需要拡大に伴い売上収益は2年前倒しで27/3期に達成見通し。調整後営業利益率は28/3期の達成をめざす。

達成時期	従来の中期目標*1	見直し後の中期目標	アプリケーション別売上構成比*3	
	WFE市場規模 1,200億ドル以上	2029年3月期まで		
売上収益	3,300億円以上	3,300億円以上		
装置ビジネス 売上比率	75%程度	80%程度		
サービスビジネス 売上比率	25%程度	20%程度		
調整後営業利益率*2	30%以上	30%以上		
研究開発費 (対売上収益比率)	6%以上	6%以上		
ROE(参考)	25%以上	25%以上		
ROIC(参考)	23%以上	23%以上		

約50%

約25%

約25%

約40%

約40%

約20%

従来

見直し後

サービス

Logic/Foudry+その他

DRAM

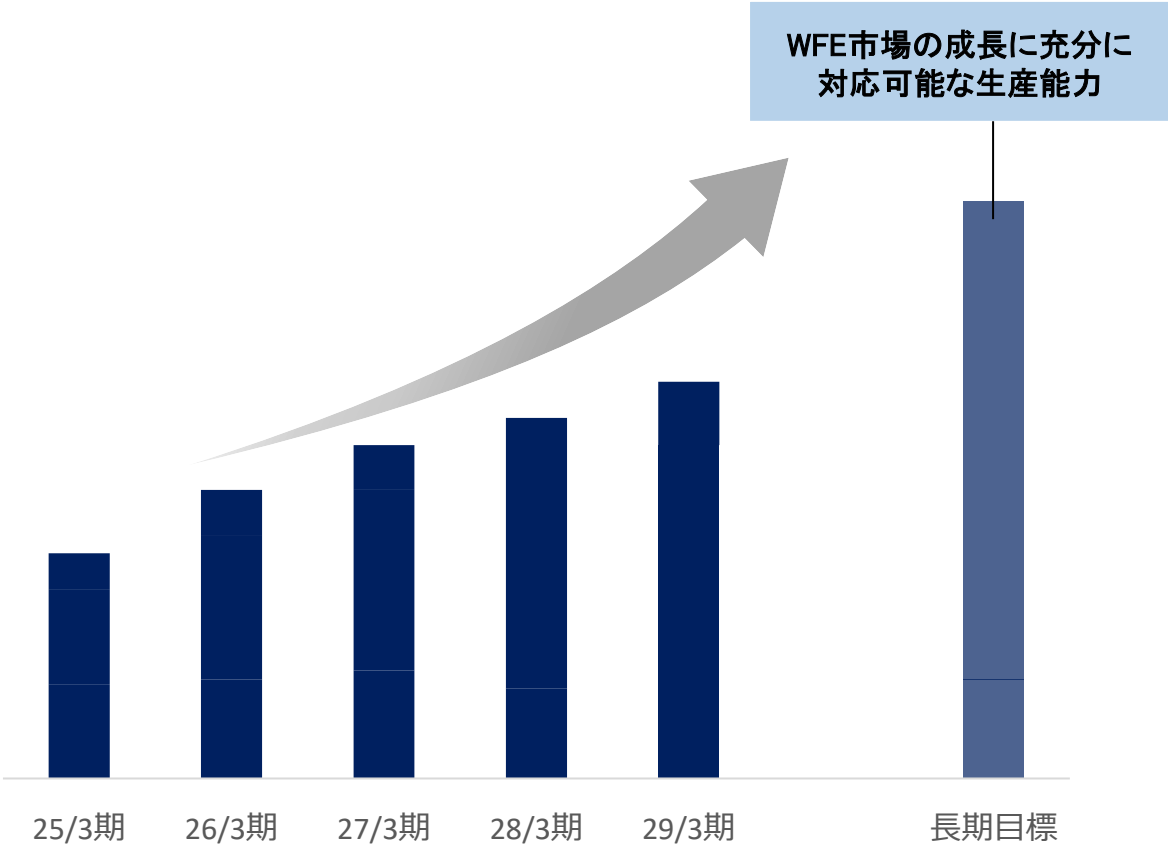
NAND

*1: 中長期事業目標に関して足許の環境や進捗状況を踏まえた現時点における中計の着地見込みを中期事業目標と記載
*2: 調整後営業利益率 = 調整後営業利益 ÷ 売上収益
調整後営業利益 = 営業利益 - その他の収益 + その他の費用 + 企業結合により識別した無形資産等の償却 + 事業再編費用 + 株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)
*3: 装置売上の比率

生産体制について

27/3期の生産稼働率は、上期平均で70%～80%、下期平均で80%以上。28/3期はさらに高まる見通し。
WFE市場の急速な変化に対応すべく生産能力を引き続き強化し、充分対応可能な生産体制を維持。

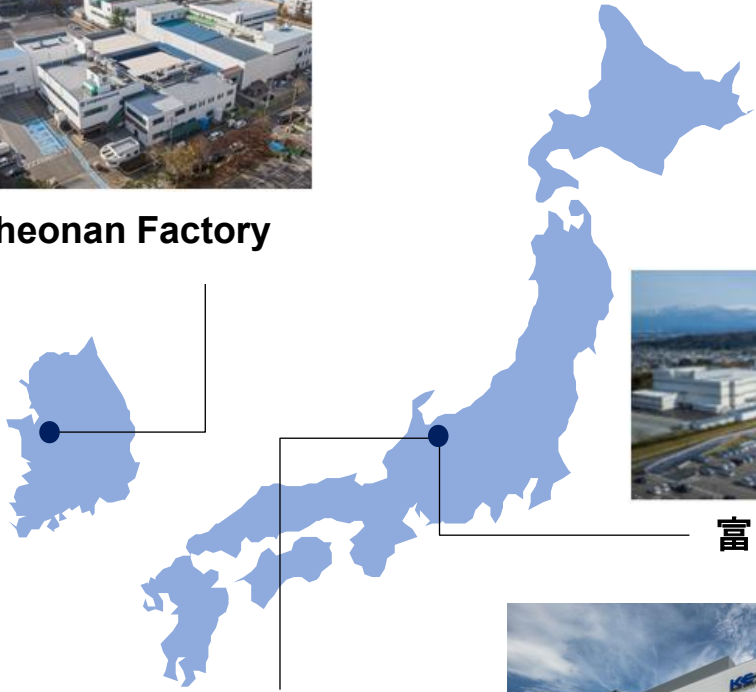
生産能力の増強



生産拠点(日本・韓国)



Cheonan Factory



富山事業所



砺波事業所
(2026年4月、生産能力増強のため隣接地を取得済)

株主還元方針に基づく施策について

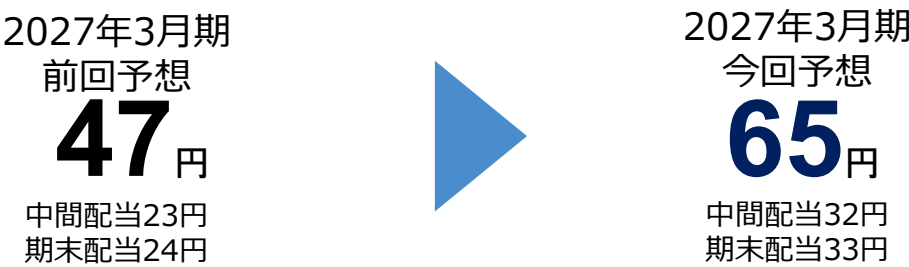
27/3期業績予想の上方修正により年間配当予想を47円（調整後当期利益ベースの配当性向25.6%）から65円（同25.2%）へ18円増配。

26/3期業績を受けた自己株式取得は7月27日に完了。消却は8月31日に予定。

株主還元方針について

- 連結配当性向20%から30%程度を目安に剰余金の配当
- ネットキャッシュ^{*1}がプラスに転換後、有利子負債分割償還後フリー・キャッシュ・フロー^{*2}の70%程度に相当する金額を配当及び自己株式取得に充当。取得した自己株式は消却を原則とする^{*3}
- 配当と自己株式取得を合わせた総還元性向は、中期目標達成時に約50%を見込む

年間配当について



自己株式の取得と消却について

- 取得期間 2026年5月14日～2026年7月27日
- 取得した株式の総数 565,900株
- 株式の取得価額の総額 5,299,480,480円
- 取得の方法 株式会社東京証券取引所における市場買付
- 消却する株式の総数 565,900株
- 消却予定日 2026年8月31日

（参考）

	発行済株式総数	保有自己株式数
2026年7月31日時点	238,115,614株	4,731,768株
2026年8月31日時点 ^{*4}	237,549,714株	4,165,868株

^{*1}: ネットキャッシュ＝現金及び現金同等物－有利子負債
^{*2}: 有利子負債分割償還後フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー－有利子負債の分割償還額
^{*3}: ただし、株式報酬制度等により活用が見込まれる発行済株式総数の1%を上限に保有
^{*4}: 自己株式消却後。ただし、8月1日以降の株式報酬付与等は含まず

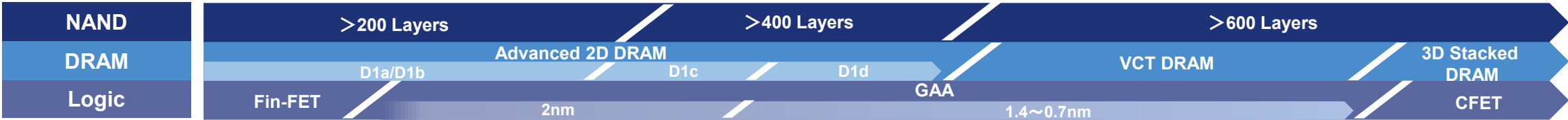
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION and its Affiliates Proprietary
Copyright © KOKUSAI ELECTRIC Corporation 2026. All rights reserved.

まとめ

半導体デバイスの進化に伴う多層化、微細化、複雑化、三次元化により高付加価値製品の適用機会が拡大、技術的優位性を生かして市場成長を上回る事業拡大の持続をめざす。

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
------	------	------	------	------	------	------	------

ロードマップ
デバイス



事業環境

短期

- NAND
 - 世界各国向けは世代交代投資が継続(200~400層)し、生産規模拡大投資の再開に期待。
 - 中国地場向けは端境期も2026年後半から投資再開。
- DRAM
 - AI需要の拡大により、世代交代、生産規模拡大に向けた投資が継続。
- Logic/Foundry+その他
 - 世代交代、生産規模拡大投資が継続。
 - 中国地場向けは、大手メーカーによる投資が継続。

中期

- NAND
 - 世界各国向けは世代交代投資が継続(400~600層)、AI需要により生産規模拡大投資が再開。
 - 中国地場向けは世代交代投資が中心となる見通し。
- DRAM
 - D1d~VCT DRAM、への世代交代、生産規模拡大に向けた投資が活発化。
- Logic/Foundry+その他
 - GAA 2nm、1.4nmへの世代交代、生産規模拡大投資の活発化。Fin FET 3nmへの投資拡大。
 - アドバンスドパッケージ市場の拡大。

長期

- NAND
 - 世界各国向けは600層以上の世代交代に向けた投資が活発化、生産規模拡大投資も継続。
- DRAM
 - VCT DRAM、3D Stacked DRAMへの世代交代、生産規模拡大に向けた投資が活発化。
- Logic/Foundry+その他
 - CFETへの世代交代、生産規模拡大投資が活発化。
 - アドバンスドパッケージ市場のさらなる拡大。

当社
カタリスト

短期~中期

- AI需要による高性能DRAM、Logic/Foundryの投資拡大を背景に、高付加価値製品の適用機会が拡大。
- NANDは世代交代投資の継続により高付加価値製品の需要増加、生産規模拡大にも期待。
- 競争優位性のある成膜技術をアドバンスドパッケージ分野で活用、新規PORを獲得。
- 出荷台数の増加によるインストールベースの台数増加で、サービスビジネス拡大に期待。

長期

- CFET、VCT DRAM、3D Stacked DRAM、600層以上NANDへの世代交代に伴う需要拡大。
- アドバンスドパッケージ分野の拡大と新規需要の開拓。



Appendix

2027年3月期第1四半期の主な活動報告

経営・事業活動

- TechInsightsの顧客満足度調査「Global Semiconductor Supplier Awards」で「Top 10 Customer Service」を29年連続で受賞。(26/5)
- ALD/ALE2026で招待講演およびポスター発表。(26/6)
- 砺波事業所に隣接する土地を新たに取得することを決定。(26/4)
- 「MEMS Engineer FORUM 2026」に出展。(26/4)
- 2025年度で縦型装置の累計出荷台数が20,000台を突破。(26/4)



TechInsightsの顧客満足度調査で
「Top 10 Customer Service」を29年連続で受賞

ESGの取り組み

- ESG投資の主要指数「FTSE 4 Good Index Series」、「FTSE JPX Blossom Japan Index」、「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に選定。(26/6)
- 保育所施設で青空環境教室を開催。(26/5)
- CDP2025「サプライヤーエンゲージメント評価」で2年連続最高評価を獲得。(26/5)
- ISS STOXXの「ESGコーポレートレーティング」で「Prime」評価に初認定。(26/5)
- 富山県砺波市で開催された「2026となみチューリップフェア」に協賛。(26/4)

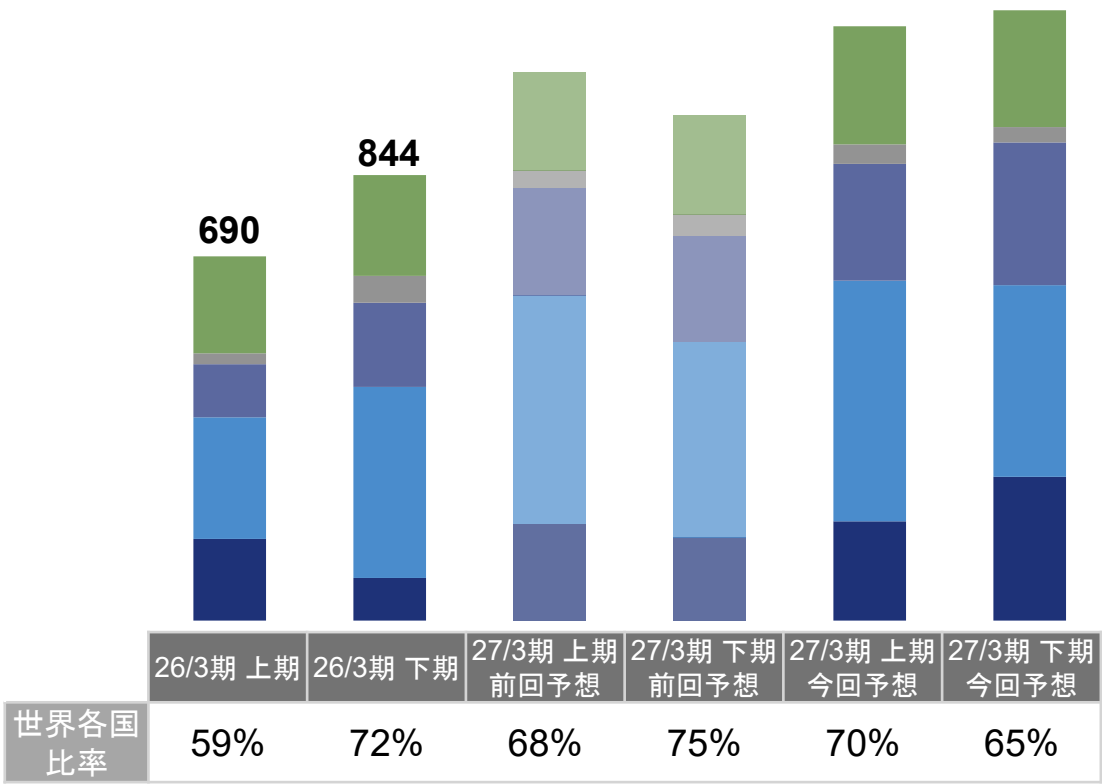


CDP2025「サプライヤーエンゲージメント評価」で
2年連続最高評価を獲得

2027年3月期業績予想 アカウント別*1上下別売上収益

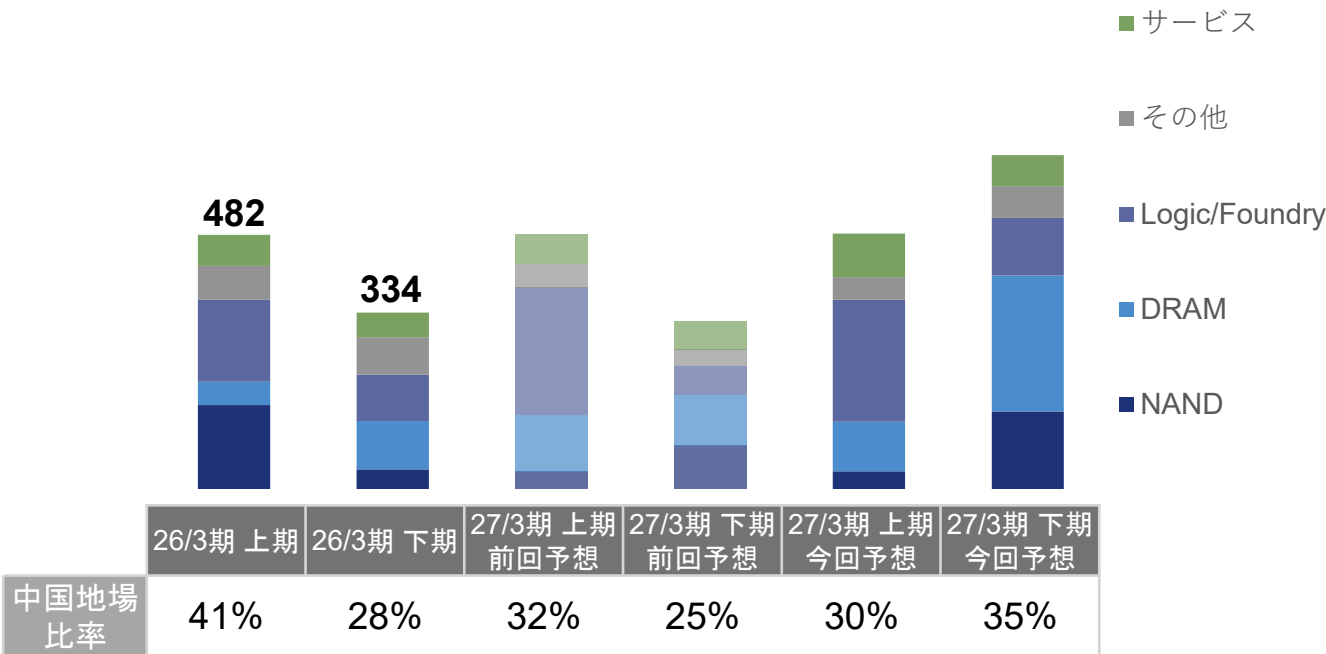
世界各国向け売上収益

(億円)



中国地場向け売上収益

(億円)



*1 世界各国デバイスメーカー（中国以外に本拠のあるメーカー）向け、中国地場デバイスメーカー向けの区分

損益計算書及び研究開発費、設備投資額、減価償却費

(百万円)	26/3期					27/3期
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q
売上収益	51,789	65,416	55,852	62,021	235,079	75,414
売上総利益	22,220	27,277	22,883	24,430	96,810	30,678
売上総利益率	42.9%	41.7%	41.0%	39.4%	41.2%	40.7%
調整後営業利益	10,902	14,439	11,290	10,965	47,596	17,371
調整後営業利益率	21.1%	22.1%	20.2%	17.7%	20.2%	23.0%
調整後当期(四半期)利益	7,598	9,785	8,292	8,420	34,095	12,548
調整後当期(四半期)利益率	14.7%	15.0%	14.8%	13.6%	14.5%	16.6%
営業利益	9,717	12,993	9,809	9,317	41,836	15,926
営業利益率	18.8%	19.9%	17.6%	15.0%	17.8%	21.1%
税引前当期(四半期)利益	9,322	12,840	9,412	9,165	40,739	15,742
税引前当期(四半期)利益率	18.0%	19.6%	16.9%	14.8%	17.3%	20.9%
当期(四半期)利益	6,776	8,782	7,264	7,277	30,099	11,558
当期(四半期)利益率	13.1%	13.4%	13.0%	11.7%	12.8%	15.3%
研究開発費	3,851	4,821	4,159	5,427	18,258	4,462
設備投資額	2,302	5,208	4,015	5,337	16,862	4,830
減価償却費	3,417	3,498	3,629	3,734	14,279	3,931

調整後利益等の計算における調整項目

(百万円)	26/3期					27/3期
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q
営業利益	9,717	12,993	9,809	9,317	41,836	15,926
－その他の収益	△304	△83	△70	△51	△508	△56
＋その他の費用	18	53	74	223	368	21
(調整額)						
＋企業結合により識別した無形資産等の償却 ^{*1}	1,476	1,476	1,477	1,476	5,905	1,476
＋事業再編費用	-	-	-	-	-	4
＋株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)	△5	-	-	-	△5	-
調整額 計	1,471	1,476	1,477	1,476	5,900	1,480
調整後営業利益	10,902	14,439	11,290	10,965	47,596	17,371
当期(四半期)利益	6,776	8,782	7,264	7,277	30,099	11,558
－その他の収益	△304	△83	△70	△51	△508	△56
＋その他の費用	18	53	74	223	368	21
(調整額)						
＋企業結合により識別した無形資産等の償却 ^{*1}	1,476	1,476	1,477	1,476	5,905	1,476
＋事業再編費用	-	-	-	-	-	4
＋株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)	△5	-	-	-	△5	-
－調整項目に対する税金調整額	△363	△443	△453	△505	△1,764	△455
調整後当期(四半期)利益	7,598	9,785	8,292	8,420	34,095	12,548

^{*1}: 26/3期末時点で技術関連資産の帳簿価格は5,649百万円、残存償却期間は2年
26/3期末時点で顧客関係資産の帳簿価格は38,740百万円、残存償却期間は12年

貸借対照表及び主要財務指標

			26/3期				27/3期
(百万円)			1Q末	2Q末	3Q末	4Q末	1Q末
資産	流動資産	現金及び現金同等物	42,766	43,806	47,728	56,543	56,974
		営業債権及びその他の債権	39,087	38,066	36,152	37,941	42,223
		棚卸資産	89,626	89,326	92,758	88,890	93,702
		その他	2,038	2,065	2,905	2,465	2,467
		流動資産合計	173,517	173,263	179,543	185,839	195,366
	非流動資産	有形固定資産	47,220	50,214	51,916	53,975	56,370
		のれん	59,065	59,065	59,065	59,065	59,065
		無形資産	53,182	52,013	51,321	50,900	49,978
		その他	8,524	8,765	10,262	9,879	10,110
		非流動資産合計	167,991	170,057	172,564	173,819	175,523
資産合計			341,508	343,320	352,107	359,658	370,889

			26/3期				27/3期
			1Q末	2Q末	3Q末	4Q末	1Q末
(百万円)							
負債	流動負債	借入金＋リース負債	11,956	12,044	12,161	12,373	12,462
		営業債務及びその他の債務	24,574	25,658	26,361	25,354	31,476
		契約負債	25,069	21,704	27,666	34,840	32,844
		その他	17,991	18,687	15,263	18,162	19,639
		流動負債合計	79,590	78,093	81,451	90,729	96,421
	非流動負債	借入金＋リース負債	48,339	42,365	43,681	37,492	37,927
		その他	14,663	14,553	14,131	12,167	11,641
		非流動負債合計	63,002	56,918	57,812	49,659	49,568
		負債合計		142,592	135,011	139,263	140,388
資本合計			198,916	208,309	212,844	219,270	224,900
負債及び資本合計			341,508	343,320	352,107	359,658	370,889

	26/3期				27/3期
	1Q末	2Q末	3Q末	4Q末	1Q末
自己資本比率	58.2%	60.7%	60.4%	61.0%	60.6%
D/Eレシオ	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
ネット・キャッシュ(百万円)	△ 17,529	△ 10,603	△ 8,114	6,678	6,585

キャッシュ・フロー計算書

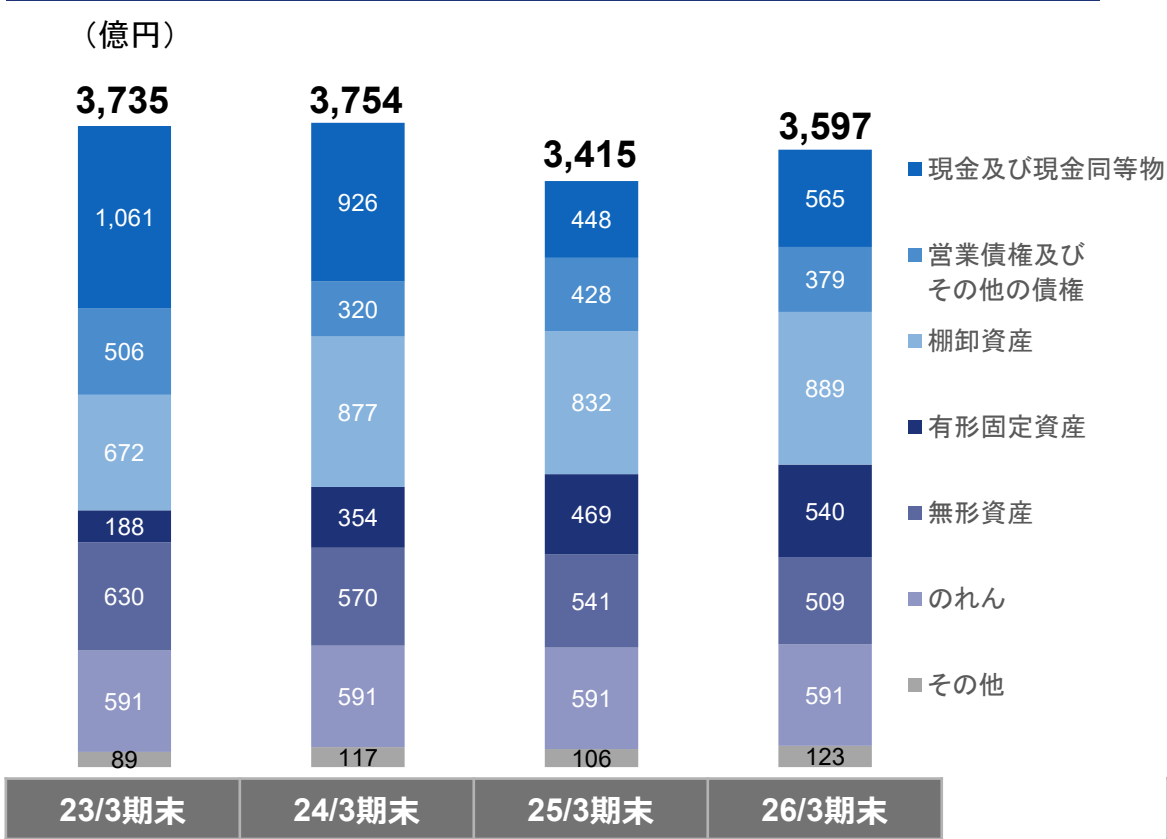
(百万円)

	26/3期					27/3期
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,923	11,936	11,538	20,404	48,801	12,127
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,942	△ 4,789	△ 4,263	△ 4,960	△ 16,954	△ 5,520
フリー・キャッシュ・フロー	1,981	7,147	7,275	15,444	31,847	6,607
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,423	△ 6,373	△ 4,339	△ 6,379	△ 21,514	△ 6,446
現金及び現金同等物の期首残高	44,755	42,766	43,806	47,728	44,755	56,543
現金及び現金同等物の四半期末残高	42,766	43,806	47,728	56,543	56,543	56,974

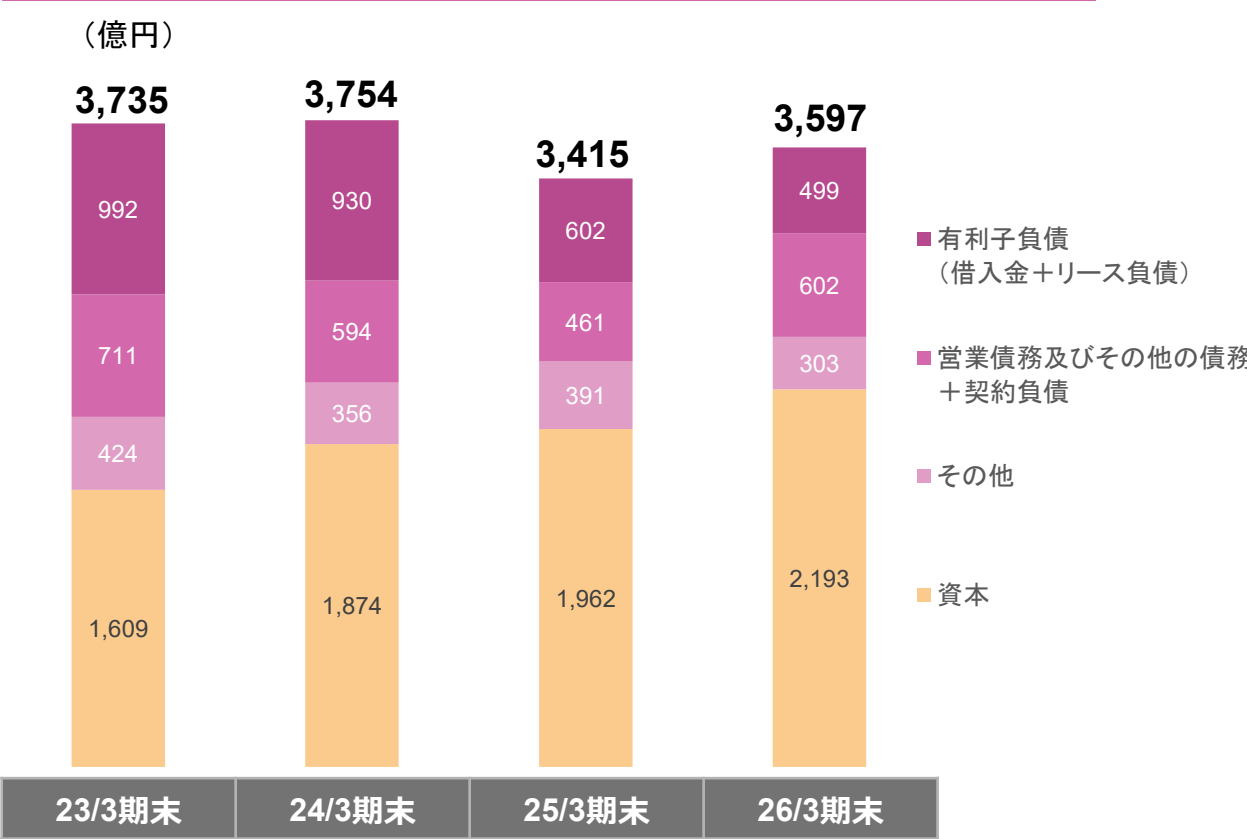
貸借対照表(5月13日公表)

当期末の資産合計は、現金等の増加、米国デモセンター設立に伴う投資等による有形固定資産の増加により前期末比で181億円増加。資本合計は利益剰余金の増加等により、前期末比で231億円増加。

資産



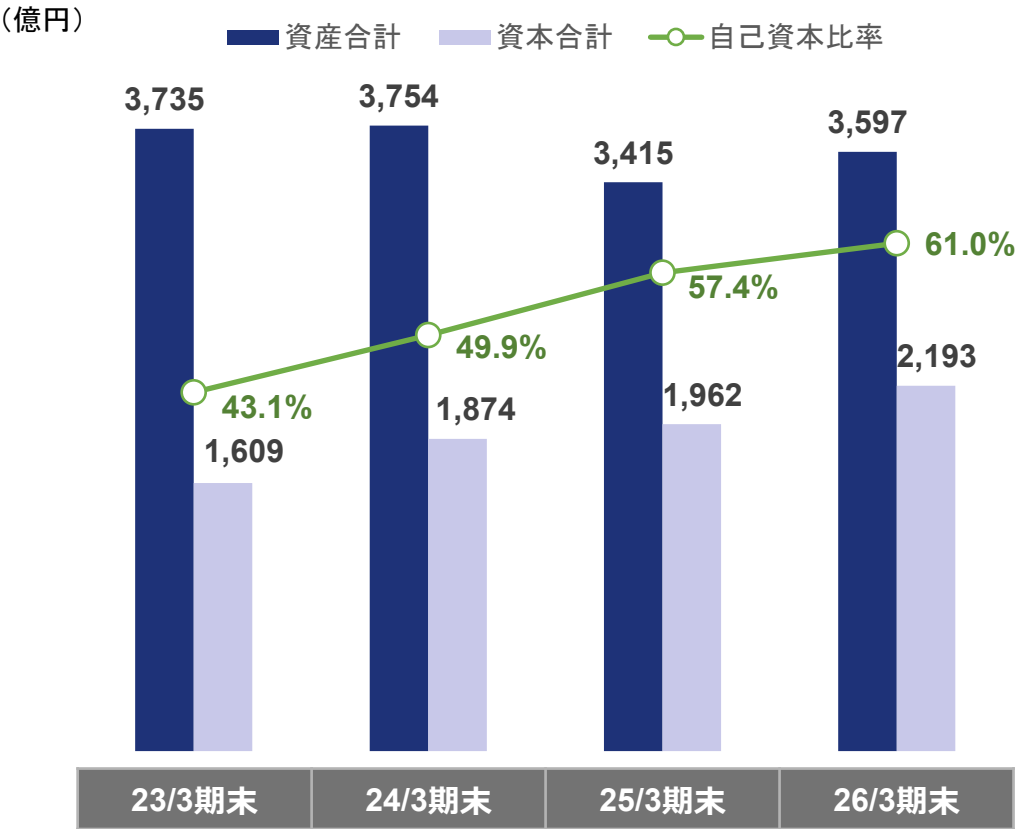
負債・資本



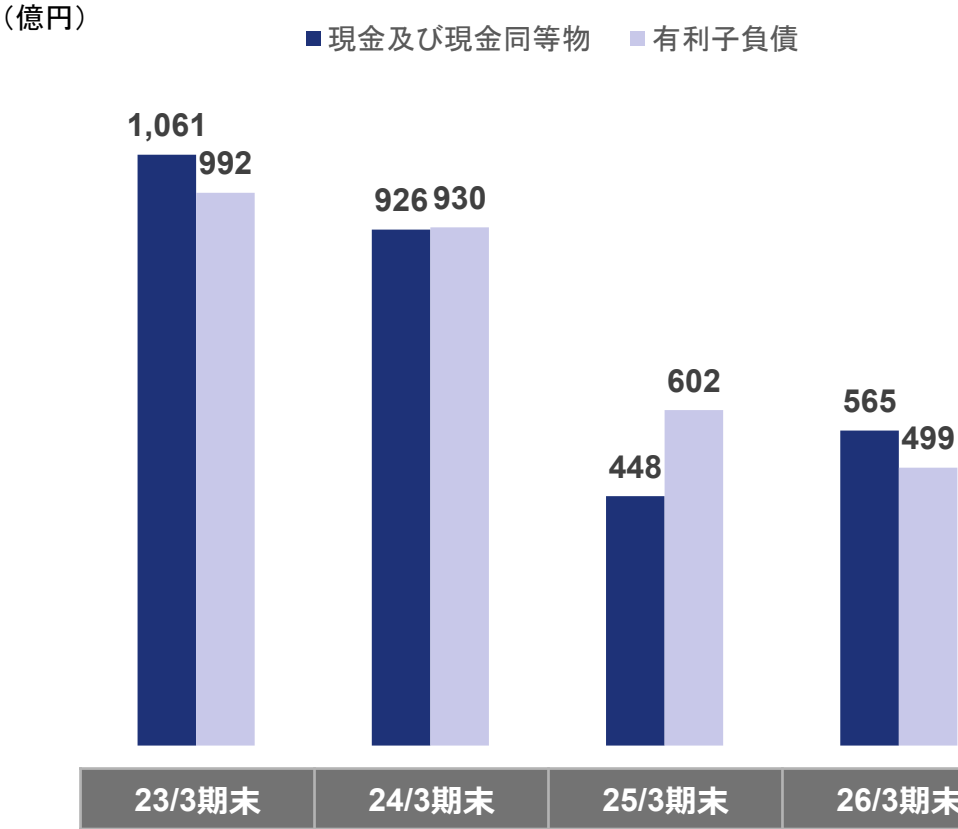
自己資本比率 & 現金及び現金同等物／有利子負債(5月13日公表)

当期末の自己資本比率は61%に上昇。現金等の増加に加え借入金の返済による有利子負債の減少によりネットデットを解消し、当期末のネットキャッシュは66億円に。

資産合計／資本合計／自己資本比率

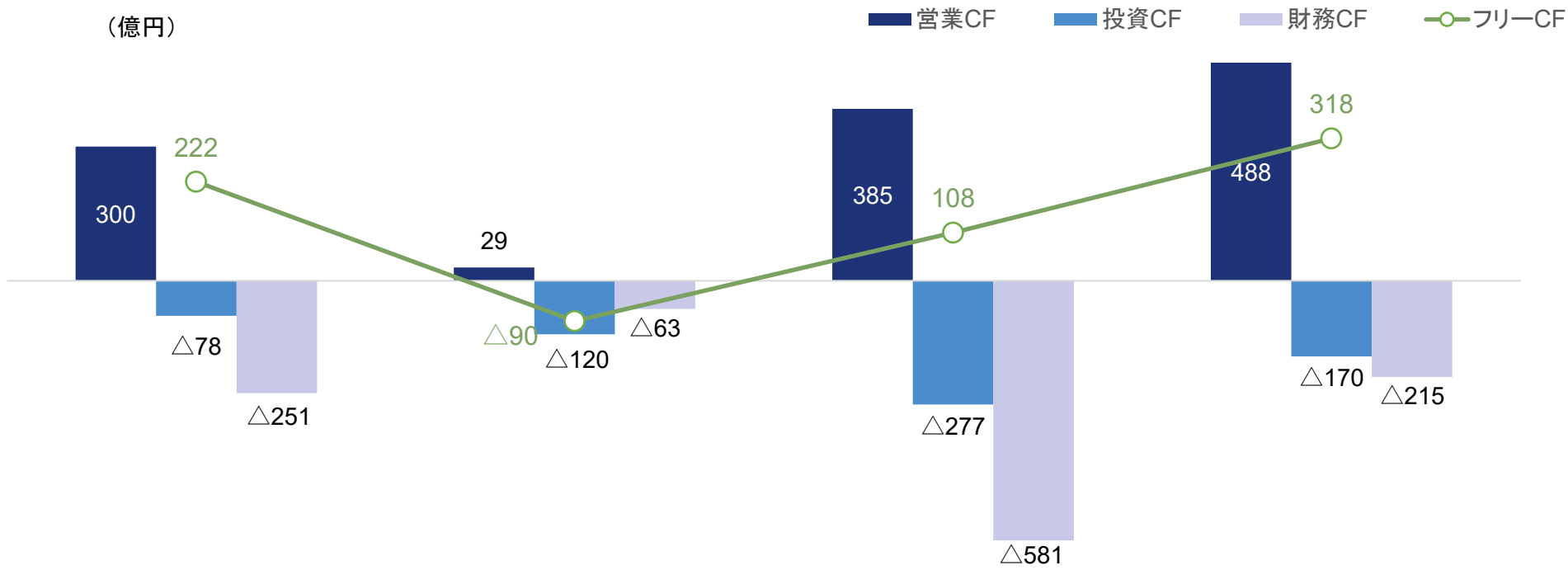


現金及び現金同等物／有利子負債



キャッシュ・フロー(5月13日公表)

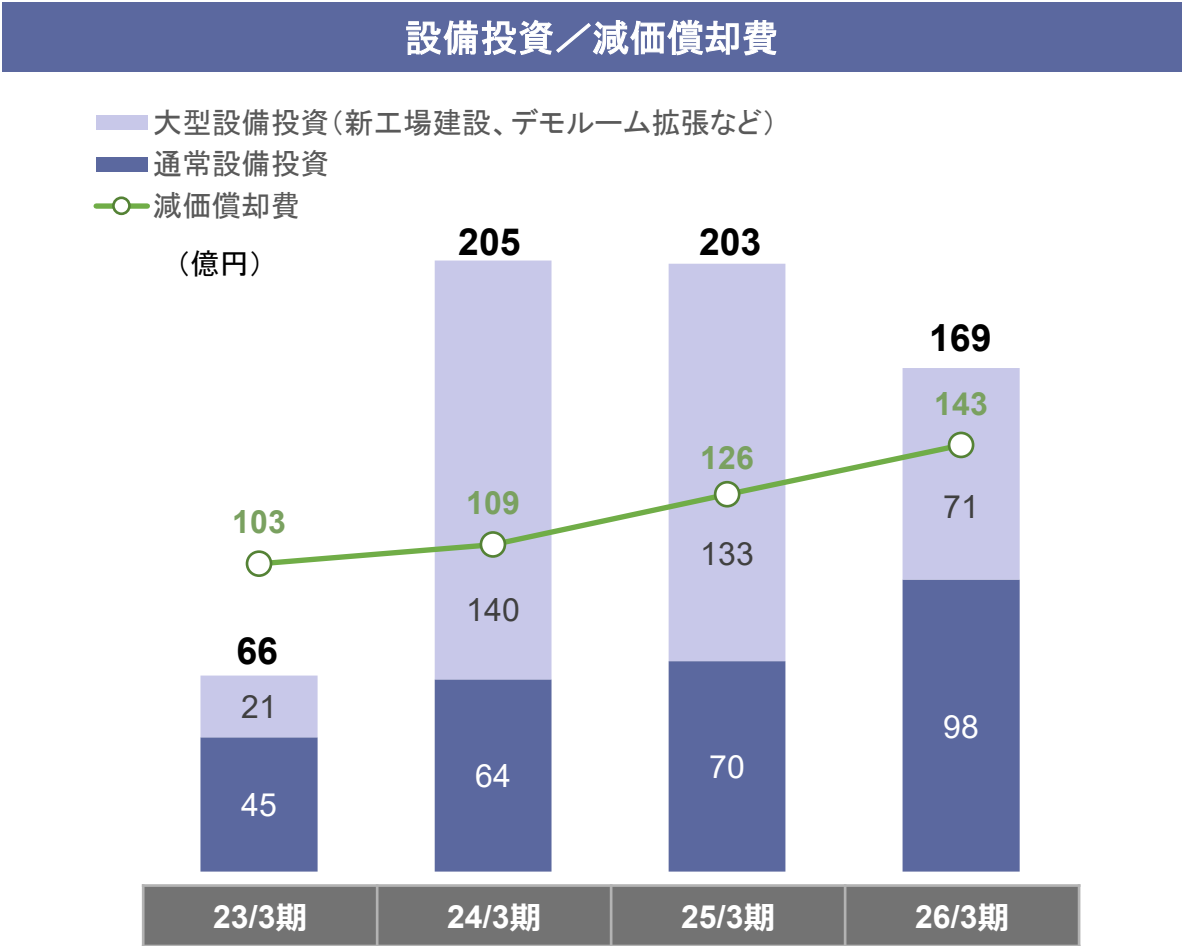
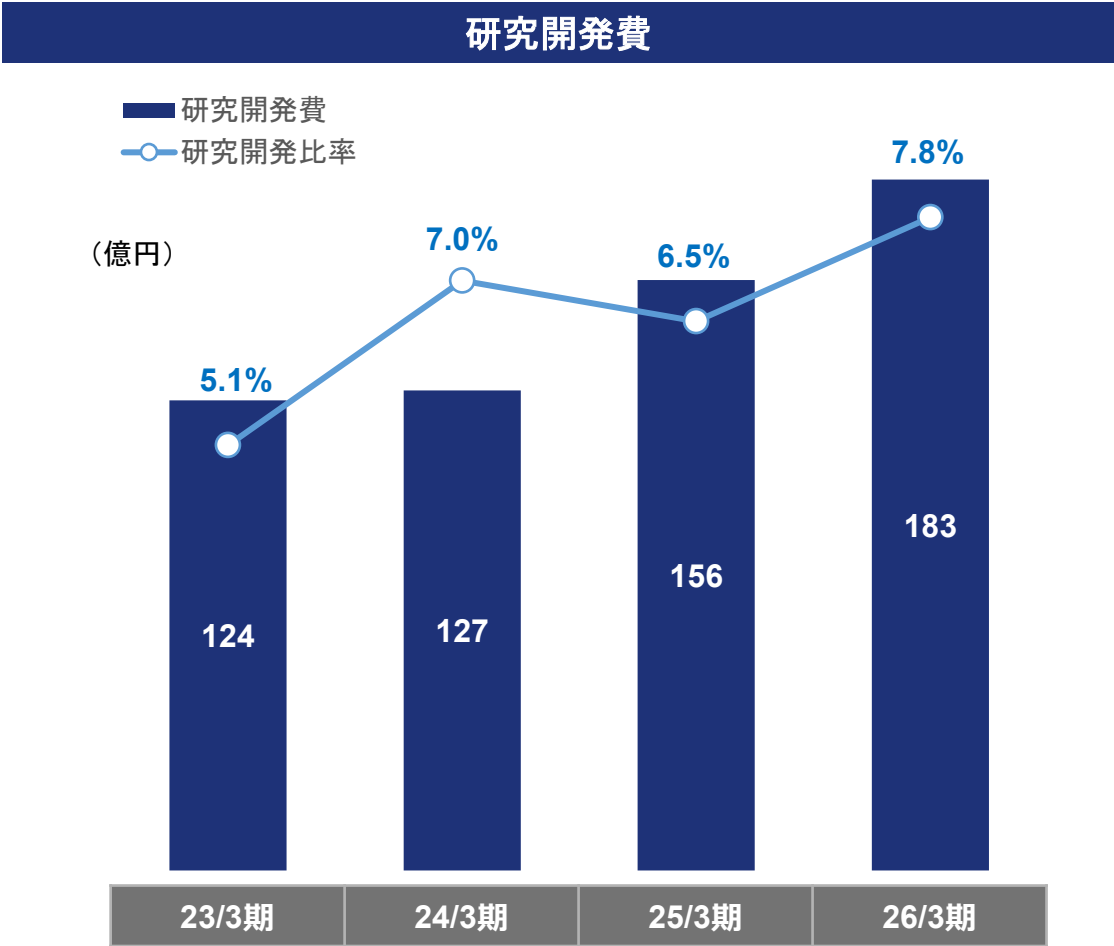
営業CFが投資CFを上回り、フリーCFは318億円の収入。
財務CFは借入金の返済と配当金の支払いによる支出等により、215億円の支出。



(億円)	23/3期	24/3期	25/3期	26/3期
営業CF	300	29	385	488
投資CF	△78	△120	△277	△170
財務CF	△251	△63	△581	△215
フリーCF	222	△90	108	318
現金及び現金同等物残高	1,061	926	448	565

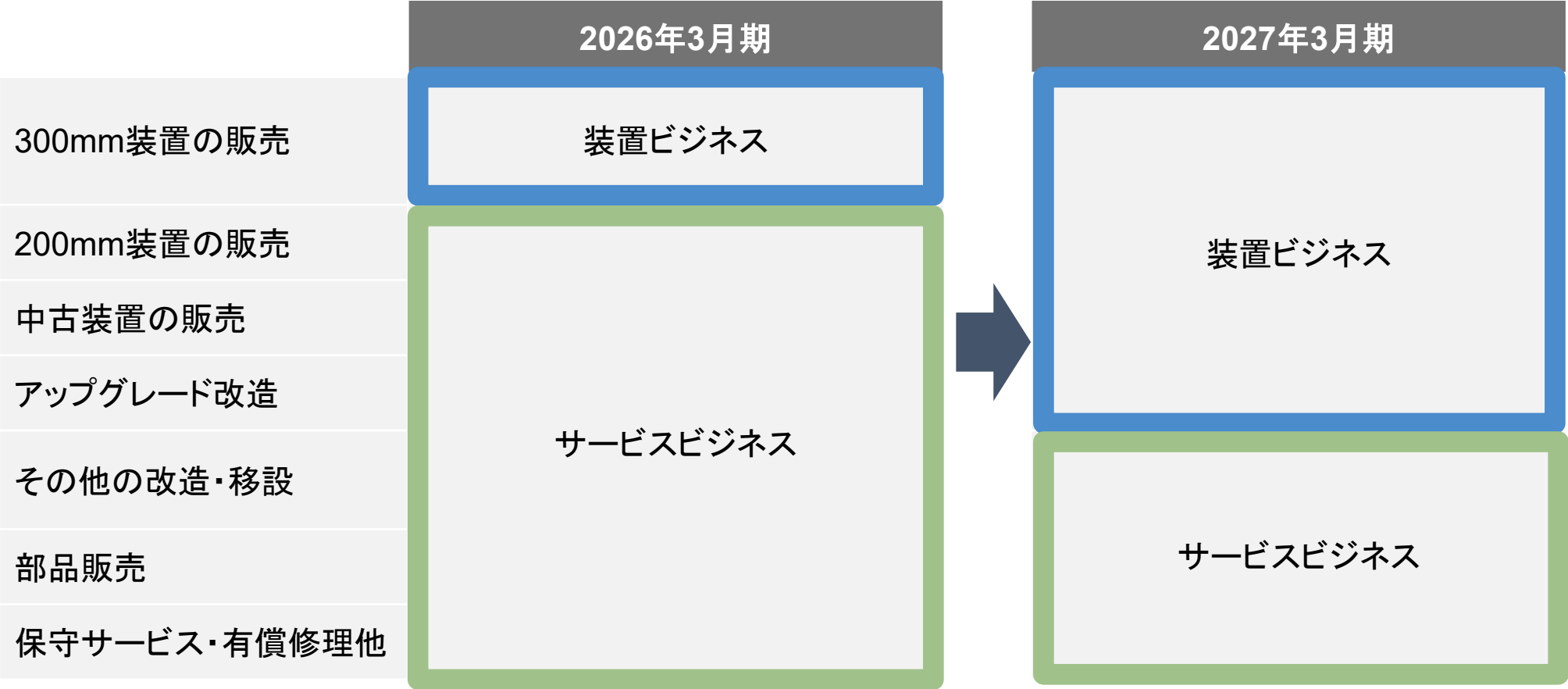
研究開発費／設備投資／減価償却費(5月13日公表)

中長期的な需要拡大を見据え、中計に沿って研究開発投資、設備投資を実施。
研究開発費は前期比2割増。設備投資は前期比2割減、減価償却費は前期比1割増。



ビジネス区分の変更(5月13日公表)

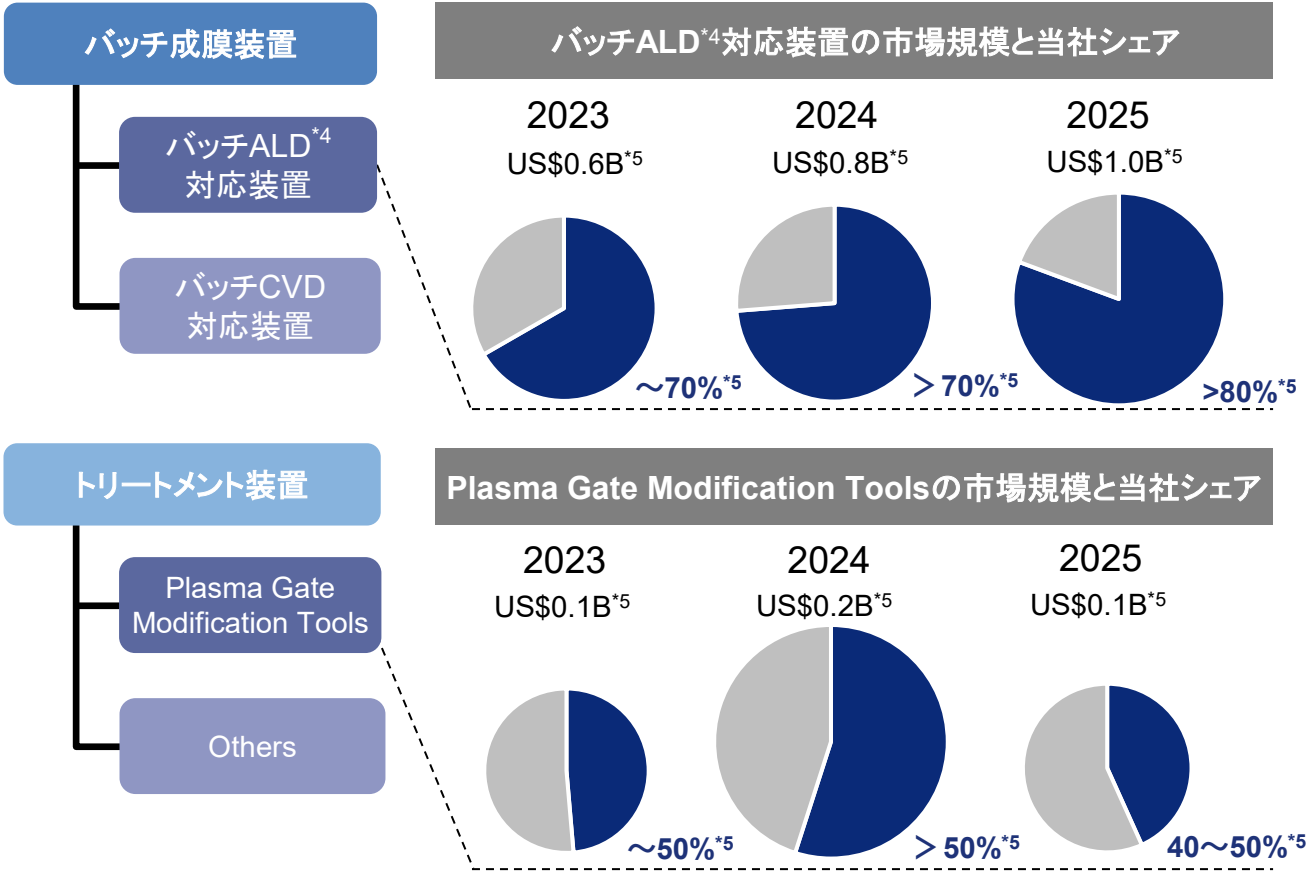
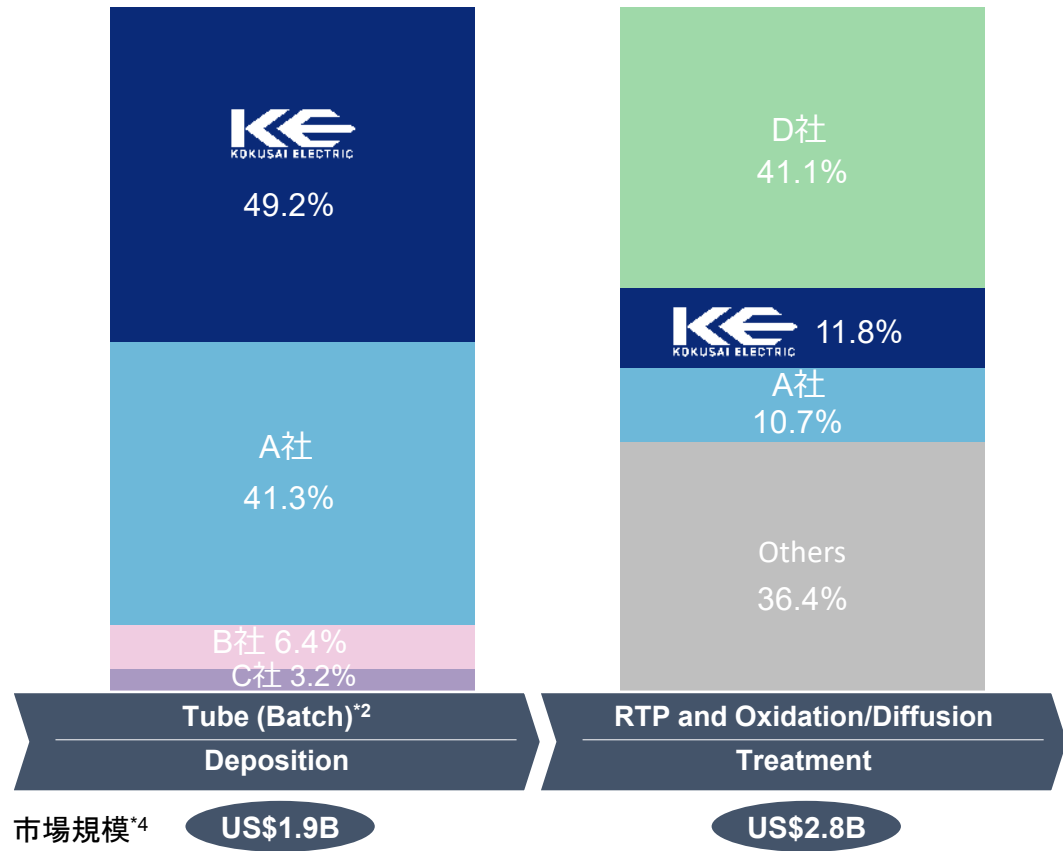
2027年3月期より、ビジネス区分を変更。これまでサービスビジネスに属していた「200mm装置の販売」と「中古装置の販売」、「アップグレード改造」を装置ビジネスに移管。よりWFE市場と連動した開示区分へ。



マーケットシェアの推移(5月13日公表)

CY25は、バッチ成膜装置市場においてトップシェアを獲得。
バッチALD^{*1}対応装置シェアは80%に到達、枚葉トリートメント装置 (Plasma Gate Modification Tools) もトップシェアを維持^{*2}。

(CY25) Gartnerの分類に基づく市場シェア^{*3}



^{*1} 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。
^{*2} GartnerによるWFEセグメントにおける「Tube CVD」を「Tube (Batch)」と定義 (当社にて算出)。
^{*3} 出典: Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2025, Bob Johnson et al. Published 2 April 2026
^{*4} 図はガートナーリサーチに基づき、Kokusai Electricが作成。ここに記載のある数値は、Kokusai Electricにより算出されたものです。
^{*5} Treatment (トリートメント装置): RTP and Oxidation/Diffusion。GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved. Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。本書に記載するGartnerのコンテンツ (以下「Gartnerコンテンツ」) は、Gartnerシンジケート・サブスクリプション・サービスの一部としてGartner, Inc. (以下「Gartner」) が発行したリサーチ・オピニオンまたは見解を表すものであり、事実を述べているものではありません。Gartnerコンテンツの内容はいずれも、そのコンテンツが発行された当時の内容であり、本書が発行された日の内容ではありません。また、Gartnerコンテンツに記載されている見解は予告なく変更されることがあります。
^{*4} Gartnerによるカテゴリーの合計値。
^{*5} 公開情報・当社売上高に基づき当社推定

砺波事業所に隣接する土地の取得を決定(5月13日公表)

2031年以降のさらなる市場拡大を見越して、富山県砺波市が所有する砺波事業所に隣接する土地の取得を決定。生産や研究開発など当社グループにおけるさまざまな取り組みに寄与する見込み。



所在地	高岡砺波スマートIC柳瀬 第2団地
敷地面積	約43,000㎡
取得価額	約10億円

用語集

- バッチ処理装置：多数のウェーハを一括処理する装置
- 枚葉トリートメント装置：ウェーハを1枚単位で処理する枚葉方式により成膜後の膜質を改善する装置
- ALD: Atomic Layer Depositionの略
当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。
- CVD: Chemical Vapor Depositionの略
- CFET: Complimentary Field Effect Transistorの略
- FinFET: Fin Field Effect Transistorの略
- GAA: Gate All Aroundの略
- HBM: High Bandwidth Memoryの略
- POR : Process of Recordの略で、顧客の半導体製造プロセスにおける製造装置認定を指す。
- TAM: Total Addressable Marketの略
- VCT: Vertical Channel Transistorの略
- WFE: Wafer Fab Equipmentの略

